UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

FACULTAD DE CIENCIAS



DISEÑO DE UN SISTEMA DE RAYOS X DE FLUORESCENCIA CON DETECTOR DE CENTELLEO.

TESIS

Que para obtener el titulo de:

FISICO

Presenta

HUGO ALBERTO ADRIANO CEBALLOS

México, D.F.



1989

- 2 ez



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor. DISEÑO DE UN SISTEMA DE RAYOS X DE FLUORESCENCIA Con detector de centelleo.

El costo de un sistema completo de rayos X de fluorescencia usando un detector semiconductor, màs un multicanal, màs la electrònica asociada es bastante alto, por lo que muchas ins-. tituciones no podrìan usar esté sistema debido a que no cuentan con los medios para su adquisiciòn. Sin embargo, en este trabajo se diseña un sistema de anàlisis quimico elemental por fluorescencia de rayos X, eficiente, de fàcil mànejo, y de bajo costo. Este sistema utiliza un detector de centelleo, un contador integral, filtros balanceados y rayos gamma como radiación primaria.

Aunque la resolución de un detector de centelleo es baja, en este trabajo se demuestra que es posible obtener un cociente señal/fondo elevado usando filtros balanceados en las energias adyacentes a las lineas de interés.

Intrinsecamente el detector de centelleo no puede discriminar entre lineas K_{α} y K_{β} de algunos elementos. Con el empleo de filtros balanceados lo estamos transformando a un sistema de mayor resolución. Una ventaja de este sistema es el hecho que el detector de centelleo tiene una mayor eficiencia que el detector semiconductor, por lo que se requieren fuentes menos intensas y tiempos de conteo menores. Otra ventaja la representa el hecho de que este sistema se puede usar de forma portàtil en lugares de difícil acceso.

Para completar nuestro estudio, se calcularon todos los filtros balanceados para rayos X de fluorescencia de todos los elementos a partir del número atòmico Z=15.

Los resultados obtenidos usando el sistema diseñado se compararon con resultados obtenidos, en este mismo trabajo, usando un detector de Germanio hiperpuro en vez del detector de centelleo y los filtros balanceados. De esta comparación se concluye que el comportamiento del sistema diseñado es equivalente al sistema con detector de Germanio hiperpuro y por lo tanto se puede sustituir.

DISEÑO DE UN SISTEMA DE RAYOS X DE FLUORESCENCIA CON DETECTOR DE CENTELLEO. INDICE

INDICE

INTRODUCCION

CAPITULO I

FUNDAMENTOS DE LOS RAYOS X DE FLUORESCENCIA

	1.1.1
I.1 Introducciòn I.2 Emisiòn caracterìstica, rayos X de fluorescencia	3 5
I.3 Interacción de radiación electromagnética	
de baja energia con la materia	8
a, Efecto fotoelectrico	8
D. Liecto Auger, rendimiento de fluorescencia	10
d. Dispersión inelàstica	12
I.4 Coeficiente de atenuación màsica	13
I.5 Discriminación de la energía con filtros	
balanceados	14
CADIMULO II	
CAPITOLO II	
EL SISTEMA XES, INSTRUMENTACION	
II.1 Detector de centelleo de NaI(T1)	18
II.2 Detector proporcional	20
II.3 Detectores de estado sòlido	23
a. Principios de operación y diseno	23
b. Resolución del detector	26
C. Eficiencia de detección	20
11.4 Sistema de excitación Excitación por radiciotoros	27
b. Excitación por medio de tubos de	21
rayos X	28
c. Excitación por particulas cargadas	31
CAPITULO III	
ANALISIS EXPERIMENTAL	
III.l Introducciòn	33
III.2 Sistema con detector de Germanio hiperpuro	34
a. Eficiencia del sistema	34
b. Anàlisis de rayos X de fluorescencia	38

Pàg. 1 III.3 Sistema con detector de centelleo de 3.8 cm x 0.1 cm y equipo integrado (Mini Scaler, modelo MS-2, Eberline)
a. Nivel de umbral del discriminador
b. Curva de discriminación de la energía con filtros balanceados Pàg.

48

48

54

63

65

74

and the second second

.

CONCLUSIONES

APENDICE

CALCULO Y LISTADO DE FILTROS BALANCEADOS

BIBLIOGRAFIA

INTRODUCCION

El anàlisis por fluorescencia de rayos X es un método instrumental que permite evaluar concentraciones a nivel de trazas de elementos en muestras de diversos tipos.

El principio de este método es el efecto fotoeléctrico, en el cual, un fotòn proveniente de una fuente externa y con una energia adecuada, incide sobre un electròn que pertenece generalmente a una de las òrbitas internas de un àtomo. Parte de la energia del fotòn remueve al electròn del àtomo y el resto de la energia del fotòn se transforma en energia del electròn removido. El àtomo queda entonces en un estado excitado; para volver a su estado base, un electròn de una de las capas superiores pasa a ocupar el sitio vacante de la òrbita interior. La diferencia de energia entre estas dos capas es emitida como rayo X, con una energia caracteristica para cada elemento; estos rayos X son llamados radiación fluorescente. En el Capitulo I se dan los fundamentos de los rayos X de fluorescencia.

La importancia de la fluorescencia de los rayos X es evidente por el extenso uso y gran número de diferentes tipos de instrumentos que fueron desarrollados para la aplicación de està técnica. En el Capítulo II se muestra la instrumentación empleada en el sistema de fluorescencia de rayos X.

El Capitulo III (anàlisis experimental) se presenta en dos partes, en la primera parte se utiliza un sistema con detector de Germanio hiperpuro, para comparar los resultados obtenidos con el sistema diseñado. Se describen los procedimientos experimentales para obtener la eficiencia del sistema, y el anàlisis por fluorescencia de rayos X.

En la segunda parte se describe el diseño de un sistema espectrométrico que usa rayos gamma como radiación primaria y rayos X fluorescentes como radiación secundaria. La radiación secundaria es analizada con filtros balanceados y registrada con un detector de centelleo de 1 mm de espesor y un contador integral. Se muestran los procedimientos experimentales para obtener los niveles adecuados de umbral del discriminador, y las curvas de discriminación de la emergía empleando filtros balanceados.

En virtud de la importancia de los filtros para proveer discriminación de la energía, se calcularon todos los filtros balanceados para rayos X de todos los elementos a partir del número atómico Z=15. Los resultados se dan en forma de listado, indicando el càlculo obtenido de las densidades superficiales de los filtros adyacentes, los elementos de interés y las líneas en ventana (H.A. Adriano, et al, 1986). Este listado se da en el Apéndice.

Las ventajas del sistema de rayos X de fluorescencia con detec-

tor de centelleo descrito en este trabajo son: -La utilización de un equipo sencillo, de bajo costo y de fàcil manejo.

- -El empleo de filtros balanceados para proveer discriminación de la energia en forma "no dispersiva", simplificando el anàlisis de elementos via el espectro de rayos X de fluorescencia.
- -El empleo de fuentes de excitación de intensidad relativamente baja, por lo que no existe ningún riesgo de radiación al operario.
- -El anàlisis de rayos X es no destructivo.
- -El material para ser analizado puede estar en una variedad de formas, por ejemplo, sòlido, lìquido, polvo, mezcla, gas, etcétera, y uno puede en algunas circunstancias realizar el anàlisis donde màs de una forma (fase) este presente en el espécimen.
- -Los requerimientos para la preparación de la muestra son frecuentemente minimos, y el sistema puede acomodar muestras de una variedad de tamaños, cortes y formas.

3 CAPITULO_I FUNDAMENTOS DE LOS RAYOS X DE FLUORESCENCIA. oducción.

I.l Introducción.

the state of the second s

Usualmente toma una década o varias decadas, desde un descubrimiento hasta sus aplicaciones pràcticas. Este no fue el caso con los rayos X. Estos fueron aplicados inmediatamente en radiografias médicas e industriales después de un año de su descubrimiento (Roentgen, 1895).

El desarrollo històrico de la espectrometria de rayos X se resume en la tabla siguiente:

1895	W.C. Roentgen (premio Nobel de Fisica en 1901)	Descubrimiento de los rayos X.
1896	A.W. Wright	Primer papel radiogràfi- co, ronthenograma.
1896	J. Perrin (premio Nobel de Fisica en 1926)	Mediciòn de la intensi- dad de rayos X con una càmara de ionizaciòn.
1903	Sir William Crookes	Detección de los cente- lleos producidos por par- tículas alfa en películas delgadas de cristales de sulfuro de zinc.
1909-1911	C.G. Barkla (premio Nobel de Fisica en 1917)	Descubrimiento de los bor- des de absorciòn y series de lìneas de emisiòn.
1912	M. Von Laue, W. Friedrich, y E.P. Knipping.	Difracciòn de rayos X por cristales.
1912	J. Chadvick (premio Nobel de Fisica en 1935)	Detecciòn de rayos X caracterìsticos inducidos por partìculas alfa.
1913	W.L. Bragg, y W.H. Bragg (premios Nobel de Fìsica en 1915)	Espectròmetro Bragg de rayos X.
1913 	W.D. Coolidge	Tubo de rayos X, de alto vacio y filamento caliente. Medición del espectro de rayos X, de los elementos

quimicos.

1922	A. Hadding	Aplicación del espectro de rayos X para anàlisis quimico de minerales.
1923	G. Von Hevesy (premio Nobel de Quimica en 1943)	Anàlisis cuantitativo por excitaciòn secundaria del espectro de rayos X.
1928	R. Gloker, y H. Schreiber.	Aplicación de la espectro- metria de fluorescencia de rayos X.
1947		Desarrollo de los detec- tores de centelleo con tubos fotomultiplicadores.
1948	H. Fredman, y	Primer prototipo comercial

Primer prototipo comercial de un espectròmetro de emisiòn de rayos X.

Desarrollo de los detectores de alta resolución Si(Li), Ge(Li).

Desarrollo de los detectores de Germanio hiperpuro.

En la clasificación màs general, el anàlisis de rayos X es aplicado para la caracterización de materiales, es decir, una determinación de propiedades.

La energia espectroscòpica de rayos X, (XES), usada para caracterizar materiales exhibe capacidades para:

- El anàlisis elemental, i.e., la determinación de la composición de elementos (espectroguímica).
- Difracción de rayos X para la determinación de la estructura atòmica (cristalografía).

Las ventajas de ésta técnica anàlitica (XES), son:

*El anàlisis de rayos X es no destructivo.

L.S. Birks.

1960-1970

- *el anàlisis de elementos via el espectro de rayos X caracteristicos es simplificado debido a la relativa simplicidad del mismo.
- *El material a ser anàlizado puede estar en una variedad de formas, i.e., sòlido, lìquido, polvo, mezcla, gas, etc., y uno puede en algunas circunstancias realizar el anàlisis – donde màs de una forma (fase) este presente en el espécimen. *Los requerimientos para la preparación de la muestra son fre-
- cuentemente minimos, y los sistemas pueden acomodar muestras de una variedad de tamaños, cortes y formas.

*La capacidad intrìnseca del "XES", para analizar un

amplio intervalo de elementos simultàneamente con información en "tiempo real".

5. .

*La alta eficiencia de detección es proporcionada en muchos casos por la simplificación de la fuente de excitación; por ejemplo, el uso de fuentes radioactivas compactas.

- *Un intervalo dinàmico amplio, es decir, 100% de concentración a menos de 1 p.p.m.
- *El uso de filtros balanceados en un contador proporcional o un detector de centelleo para proveer discriminación de la energia.

I.2 Emisiòn Caracteristica, Rayos X de Fluorescencia.

Para nuestra descripción, es suficiente el uso de la imagen simplificada del àtomo como una estructura de capas esféricas (modelo de Bohr).

Los electrones atòmicos estàn ligados al nùcleo, por virtud de la interacción electrostàtica. La cuantización de la energia y el principio de exclusión de Pauli, permiten a los electrones ocupar ùnicamente "capas" con energias bien definidas (discretas) en òrbitas esencialmente concéntricas con el núcleo. Estas capas estàn numeradas desde el nùmero l en adelante, comenzando con la capa màs interna al núcleo. Este número es llamado el número cuàntico principal n. Las capas son convencionalmente etiquetadas de la siguiente manera:

K(n=1), L(n=2), M(n=3), N(n=4), O(n=5), etc.,

La formación de los elementos atómicos està gobernada por restricciones en la formación de esta estructura de capas. Cada capa puede tener un màximo de electrones igual a 2n² (Eisberg et. al., 1979). Ademàs, cada capa electrònica està caracterizada por un valor definido llamado "energia de amarre" del electròn. Esta energia característica de una capa dada, està relacionada con la carga del núcleo (i.e., el número atòmico Z). Ademàs los niveles estàn subdivididos en un nùmero de subniveles, i.e., L_T , L_{TT} , ... , M_T , M_{TT} , ... , etcétera. La fluorescencia, o generación de radiación secundaria desde un àtomo, es generada por ciertas interacciones de particulas o radiación electromagnética con el àtomo, que producen el traslado efectivo de un electrón de una capa a otra o al exterior del àtomo. El àtomo se encuentra así en un estado excitado. De poca importancia para nuestro propòsito es la llamada excitación por resonancia. Esta toma lugar cuando un àtomo recibe

una cantidad exacta de energia elevando un electrón de un nivel a uno màs alto con un valor definido de energia. El proceso màs importante para nuestro estudio es la extracción completa de un electrón del àtomo. En este caso la condición es menos estricta, ya que se requiere solamente una energia mayor que la energia de amarre del electrón. La extracción de un electrón fuera del àtomo eleva la energia de este último por encima de la configuración estable. Subsecuentemente el àtomo intentarà recuperar su estado base regresando a la configuración electrónica original. Esto tiene lugar mediante transiciones de electrones de capas màs altas al lugar vacante. Estas transiciones electrónicas, en virtud del caràcter discreto de las capas, implica una perdida bien definida de energia del sistema atómico.

Sin embargo, los requerimientos fundamentales del balance de energia (conservación de la energia) implica la emisión de radiación electromagnética, transportando una cantidad de – energia equivalente a la diferencia de energia entre las dos capas de la transición electrónica. Esta emisión es un fotón, que denotaremos por \mathbf{x} de energia :

$$E_{r} = E_{1} - E_{f}$$

Donde ${\rm E}_f$ y ${\rm E}_i$ son la energia final e inicial en la transición. La energia ${\rm E}_r$ tiene valores que corresponden a los de los - rayos X .

La detección de estos rayos X y el anàlisis de su energia constituyen la base de la espectroscopia de energia de rayos X, (XES) .

La energia de los rayos X emitidos està dada por:

 $E = hf = hc/_{\lambda}$

donde : h=6.6256 x 10^{-27} erg-seg , λ =longitud de onda , f = frecuencia, y c = velocidad de la luz.

La Figura 1.1 muestra esquemàticamente las transiciones electrònicas que pueden ocurrir con una probabilidad razonable, posteriores a la creación de una vacancia electrònica. La creación de una vacancia es seguida por el salto de un electròn de una de las capas màs altas.

El caràcter estadistico de tales eventos produce un espectro de emisión caracteristico.



FIGURA 1.1 MODELO ATOMICO, MOSTRANDO LAS TRANSICIONES ELECTRONICAS CON LA NOTACION CONVENCIONAL PARA LAS LINEAS DE EMISION ASOCIA DAS.

2000 - 1 7

I.3 Interacción de Radiación Electromagnética de Baja -Energía con la Materia.

Los mecanismos principales de interacción de la radiación electromagnética con la materia son: la absorción fotoeléctrica, la dispersión elàstica (dispersión coherente o dispersión de Rayleigh), y la dispersión inelàstica (incoherente o dispersión de Compton).

a. Efecto Fotoeléctrico.

Para inducir rayos X característicos del àtomo, la absorción fotoelèctrica es la interacción principal. La Figura 1.2 (a) resume los rasgos característicos del efecto fotoeléctrico -(Woldseth, 1973).

La secciòn eficaz es una medida de la probabilidad para que las interacciones puedan ocurrir en un material y depende de la radiaciòn incidente y del nùmero atòmico del àtomo con el cual la interacciòn se produce. La secciòn eficaz puede expresarse como el àrea efectiva o "tamaño" del "blanco" para la interacciòn en cuestiòn, y es medida en cm². Se expresa en unidades de 10^{-24} cm², denotada como un "barn". En la absorciòn fotoelèctrica de un fotòn, la energia del fotòn es usada completamente en el proceso de expulsiòn del electròn (i. e.,energia de amarre + energia cinética del electròn). Este proceso requiere una energia mìnima o "energia critica" igual a la energia de amarre del electròn .

Como se ilustra en la Figura 1.3, la ocurrencia del efecto fotoelèctrico exhibe caracteristicas discontinuas. Estas son llamadas "bordes de absorción", y corresponden a la energia critica para la capa en cuestión. La intensidad fotoeléctrica presenta entonces màximos, que coinciden con las energias de las diferentes transiciones, es decir, una vez que la energia incidente sobrepasa a la energia de amarre la intensidad fotoeléctrica decae hasta alcanzar la siguiente discontinuidad (borde de absorción).

Se han hecho anàlisis teòricos del proceso fotoelèctrico. En la regiòn de bajas energìas, el coeficiente de absorciòn fofoeléctrica \mathcal{O}_{p}^{-} para un electròn de la capa K està dado por la relaciòn (Fermi, 1967).

 $\mathcal{O}_{p}' \quad (cm^{2}) = \frac{128\pi}{3} \frac{e^{2}}{mc} \frac{\gamma_{L}^{*3}}{\gamma_{e}^{4}} \frac{e^{-4\varepsilon} \cot^{-1}\varepsilon}{1 - e^{-2\pi\varepsilon}}$

donde ${\bf V}_k$ es la frecuencia del borde de absorción K , ${\bf V}$ es la frecuencia del fotòn incidente (mayor que ${\bf V}_k$) y

$$\mathcal{E} = \sqrt{\frac{\gamma_k}{\gamma - \gamma_k}}$$

Para energias cercanas a la energia de amarre ($\sqrt[\gamma]{}_{k}$) se



FIGURA 1.2 REPRESENTACION ESQUEMATICA DE LA INTERACCION DE RAYOS X, Y RAYOS GAMMA CON LA MATERIA (Woldseth, 1973):

- (a) EFECTO FOTOELECTRICO
- (b) DISPERSION COMPTON

puede utilizar la fòrmula aproximada

 $O_{p}^{\prime} = \frac{6.31 \cdot x \cdot 10^{-18}}{\pi^{2}} \left(\frac{\gamma_{k}}{\gamma}\right)^{8/3}$

Para àtomos pesados, el coeficiente de absorción fotoeléctrica total de un àtomo es aproximadamente 1.25 veces mayor que el coeficiente de absorción de electrones de la capa K. Las propiedades del efecto fotoeléctrico pueden ser resumidas de la siguiente manera:

I) La dependencia con la energia incidente es aproximada-mente de la forma E^{-3} , pero varia con Z; a Z pequeña el exponente se incrementa a alrededor de 3.5 . II) Para una energia dada, la intensidad es una función del número atómico Z . Expresada por electrón, la intensidad es aproximadamente proporcional a Z^3 . Con Z electrones por àtomo, la intensidad por àtomo es proporcional a z^4 .

b. Efecto Auger, Rendimiento de Fluorescencia.

El efecto Auger es un proceso atòmico que reduce la emisión de rayos X caracteristicos o el rendimiento relativo (i.e., intensidad resultante/intensidad incidente). Este efecto puede ser explicado como la reabsorción de rayos X caracteristicos en el interior del àtomo. Esto ocurre por ejemplo cuando en una de las capas se produce un rayo-X que es lo suficientemente energético como para que a su vez cree nuevas vacantes en las capas superiores del àtomo. El electrón expulsado en este caso en un electrón Auger (Figura 1.4). Este efecto, competitivo con la emisión de rayos X caracteristicos, introduce un factor denominado rendimiento de fluorescencia, el cual puede ser definido como el cociente de rayos X emitidos al número de vacantes primarios creadas y es función tanto del número atòmico como de la capa energètica de la vacante inicial.

Existe ademàs un proceso competitivo con la emisión de electrones Auger que son las transiciones Coster-Kronig; estas transiciones ocurren entre subcapas con el mismo número cuàntico principal (Valkovic, 1977).

c. Dispersión Elàstica (Rayleigh).

La dispersión elàstica es un proceso en el que los fotones de la radiación fluorescente son dispersados por los elec-trones atómicos que están fuertemente ligados al àtomo y que no pueden ser ionizados o excitados. La colisión es, sin embargo, con el àtomo considerado como una entidad y tiene un caràcter elàstico. Se trata entonces de una excitación u oscilación inducida del sistema electrónico total, con una radiación posterior en fase(coherente) con la radiación -



incidente .Entonces, la condición para la dispersión elàstica se dà para bajas energias del fotòn y àtomos con un número atòmico alto, donde los electrones estàn fuertemente ligados.

La Figura 1.3, muestra la dependencia de la sección eficaz, para la dispersión elàstica en el plomo, con la energia del fotòn. La dispersión elàstica varia aproximadamente como Z^2 , en la región de interés para el anàlisis del XES.

El interés pràctico de la dispersión elàstica, es que forma parte de la información del espectro y es posible usarla para cuantificar los efectos de absorción de la matriz en los anàlisis cuantitativos.

d. Dispersión Inelàstica (Compton).

En el proceso de dispersión inelàstica el fotón incidente choca con los electrones atòmicos como si fueran electrones libres. En este caso, el fotón perderà algo de su energia original y tendrà un cambio de dirección (i.e. de momento). Los fundamentos de este proceso de colisión entre dos particulas, estàn gobernados por las leyes de conservación de la energia y del momento. La energia del fotón dispersado es una función de la energia inicial y del àngulo de dispersión, y siempre serà menor cue la energia inicial.

La probabilidad de dispersión inelàstica (sección eficaz por àtomo) es proporcional al número atòmico Z ; su dependencia con la energia se muestra en la Figura 1.3 , y se incrementa cuando decrece la energia del fotòn. La energia proporcionada por el fotòn es considerablemente mayor que las energias de amarre de los electrones.

La posibilidad de interacción por unidad de àngulo sòlido tiene una dependencia característica con el àngulo de dispersión: en el intervalo de las energías usadas en el anàlisis de rayos X de fluorescencia, la probabilidad es minima para una dispersión entre 90° y100°. Es importante tomar en cuenta este factor para el diseño de la geometría: fuente-muestra-detector. Debido a sus características, la dispersión inelàstica puede emplearse en anàlisis cuantitativos para corregir el efecto de absorción y es un paràmetro màs a tomarse en cuenta en lo referente al modo de excitación, sensibilidad y limites de detección.

I.4 Coeficiente de Atenuación Màsica.

Cuando un haz de fotones de rayos X pasa a través de un material, algunos de los fotones sufriran interacciones con los àtomos que componen el material. Las interacciones que toman lugar son el efecto fotoeléctrico, dispersión incoherente, y dispersiòn coherente. La fracciòn de los fotones que pasan a través del material sin interactuar es descrito usando el concepto de coeficiente de atenuación másica. Supongamos que un haz de rayos X, de intensidad $I_{0}(E)$ fotones por segundo, choca con una placa diferencial de material (de densidad \S) perpendicular a la superficie. La energia de cada fotòn incidente es E y el número de fotones por segundo que interactúan con los àtomos en la placa es dI(E). Conse-cuentemente, la intensidad de fotones que son transmitidos a través de la placa sin interacción con el material es - - $I_{O}(E)$ + dI(E) , donde dI(E) es un nùmero negativo. Esto es, la intensidad transmitida es menor que la intensidad incidente. El número de fotones por segundo que interactúan en la placa es proporcional a la razòn de fotones incidentes $I_{O}(E)$ y a la masa por unidad de àrea de la placa, la cual està dada por **Q**dx. Entonces

$-dI(E) = \mu(E)$ Io(E) $e dx \dots (1)$

Donde la constante de proporcionalidad $\mu(E)$ se llama coeficiente de atenuación màsico o coeficiente de absorción màsica. Este es característico del material en la placa y de la energía de los fotones de rayos X.

Las unidades de $\mathcal{M}(E)$ son centimetros cuadrados por gramo - (cm²/g), cuando la densidad està expresada en gramos por centimetro cùbico (g/cm³) y el espesor està expresado en centimetros (cm).

Ahora bien, para una pieza de material de espesor finito x, la integración de la ecuación (l) muestra que la intensidad transmitida de fotones que no sufren interacciones en el material està dada por

 $I(E)=Io(E) exp[-\mu(E)qx]$

Esta es la ley de Beer-Lambert. El coeficiente de atenuación màsica $\mu(E)$ toma en cuenta las diferentes interacciones que pueden ocurrir en el espècimen. Esto es, $\mu(E)$ està compuesta de tres componentes principales:

$$\mathcal{M}(E) = \mathcal{O}_{p}(E) + \mathcal{O}_{coh}(E) + \mathcal{O}_{inc}(E)$$

donde $O_p(E)$ es el coeficiente de absorción màsica fotoeléc--trica, $O_{coh}(E)$ es el coeficiente de dispersión màsica cohe--

rente total,y $\mathcal{O}_{inc}(E)$ es el coeficiente de dispersión màsica incoherente total. Ambas, \mathcal{O}_{coh} y \mathcal{O}_{inc} incluyen todos los posibles àngulos de dispersión.

Puesto que el coeficiente de absorción màsica fotoeléctrica incluye la probabilidad de ionización para todas las capas en un àtomo, puede ser dividido en una suma de las probabilidades de ionización para cada capa. Es decir,

$\mathcal{O}_{p} = \mathcal{T}_{k} + (\mathcal{T}_{LI} + \mathcal{T}_{LII} + \mathcal{T}_{LIII}) + (\mathcal{T}_{MI} + \mathcal{T}_{MII} + \mathcal{T}_{MIII} + \mathcal{T}_{MIII}) + \mathcal{T}_{MIV} + \mathcal{T}_{MV} + \dots$

donde cada término expresa el coeficiente de absorción màsica para una subcapa particular del àtomo. Si la energia del fotòn incidente es menor que la requerida para ionizar una - capa particular, entonces el tèrmino para esa capa serà cero. Entonces hay discontinuidades abruptas en el valor de O_p , como función de la energia, para energias del fotòn iguales a la energia de amarre de una capa particular.

Cuando un material està hecho de una mezcla homogènea de elementos puros, el coeficiente de atenuación màsica resultante puede calcularse de la expresión:

$$M = \Sigma_j W_j M_j$$

donde \nearrow_j es el coeficiente de atenuación màsica del elemento j, presente en el material con una fracción de peso \checkmark_j . La suma es sobre todos los elementos en el material, de manera que:

$\Sigma_i W_{i=1}$

I.5 Discriminación de la Energia con Filtros Balanceados.

Los filtros balanceados son a menudo usados con un contador proporcional o un detector de centelleo para proveer una discriminación de la energia.

El principio es ilustrado en la Figura I.5 . Dos filtros son hechos de elementos adyacentes en la Tabla Periòdica, tales que sus bordes de absorción K se extiendan sobre el intervalo de energia que se va a analizar. En la Figura I.5, los rayos X-K $_{\alpha}$ del Zinc a 8.6 Kev caen dentro de la ventana de energia. Asi el Niguel y el Cobre son seleccionados como filtros.

El espesor de los dos filtros es ajustado de manera que las transmisiones sean virtualmente idénticas para energias abajo del borde de absorción K del Niquel y arriba del borde de absorción K del Cobre. El borde de absorción K del Niquel està a 8.331 Kev y el borde de absorción K del Cobre està a 8.980 Kev.



FIGURA I.5 EL PRINCIPIO DE FILTROS BALANCEADOS. LA DIFERENCIA EN TRANSMISION ENTRE LOS FILTROS DE COBRE Y NIQUEL ESTAN EN EL AREA DE LA ENERGIA EN VENTANA ENTRE LOS BORDES DE ABSORCION-K DE NIQUEL Y COBRE. (Jenkins Ron, 1981).

> Ц С

El espécimen es normalmente excitado por un radioisòtopo; por ejemplo, la linea K de la plata obtenida con una fuente de -Cd-109 puede ser usada para excitar la linea K del Zinc. Primero, se cuenta la radiación desde el espécimen (cuentas por segundo) para un tiempo t con el filtro de Cobre enfrente del detector. Después, el filtro de Cobre es removido, y la radiación es contada durante el mismo tiempo t con el filtro de Niquel enfrente del detector. La diferencia en estas dos cuentas es un resultado de la diferencia en transmisión entre los dos filtros, la cual està representada por el àrea de la "energia en ventana" de la Figura I.5. Consecuentemente, la diferencia entre las dos cuentas representarà la intensidad K_del Zinc, excluyendo todas las otras energias del espécimen.

16

Ahora bien, en la Figura I.6 se muestran las series-K del espectro de emisión del Cobre (a) sin filtro y (b) después de pasar a través de un filtro de Niquel. Puede notarse que el minimo de la curva de absorción està en una longitud de onda (λ) ligeramente màs corta que la linea K_ppero a una longitud de onda màs grande que la linea K_p, es decir, los filtros de Niquel atenùan la mayor parte de la radiación del Cobre excepto su linea K_s. En la parte (c) se muestran los coeficientes de absorción lineal del Niquel y Cobalto en función de la longitud de onda. Estos filtros discriminan la mayor parte de la radiación del Cobre excepto su linea K_s.



FIGURA 1.6

Comparación del Espectro de Radiación-X del Cobre (a) antes y (b) después de pasar a través de un Filtro de Niguel.
(c) Coeficiente de Absorción Lineal de los Filtros de Niguel y Cobalto.

CAPITULO II

EL SISTEMA XES, INSTRUMENTACION.

II.1 Detector de Centelleo de NaI(T1).

El conteo de centelleo, una de las técnicas mas antiguas de detección de radiación ha pasado por varias etapas de desarrollo a partir de los centelleos producidos por particulas alfa en películas delgadas de cristales de sulfuro de zinc, en 1903 por Sir William Crookes detectados visualmente; esta técnica pasa a ser obsoleta en los años treinta y los siguientes años se caracterizaron por el ràpido desarrollo en técnicas de conteo electrònico, usando càmaras de ionización. Sin embargo, con el desarrollo de los tubos fotomultiplicadores, a partir de 1947, el contador de centelleo ha vuelto a ocupar un lugar prominente en el conteo de radiaciones.

La Figura 2.1, (Price W.J.,1964, Knoll G.f.,1979) ilustra esquemàticamente el diagrama de bloques del detector de centelleo de NaI(T1). Un solo cristal de ioduro de sodio con baja concentración de talio es opticamente acoplado (i.e., con indice de refracción de 1.5) a un tuxo fotomultiplicador. Tipicamente el cristal mide 2.54 cm de diàmetro por 1 mm de grosor. El espesor de 127 jum de la ventana de berilio provec una ventana de entrada de tipo "luz estrecha" para rayos X. Bajo el berilio està una laminilla de aluminio de 1 jum de espesor que sirve como reflector.

Cuando el fotòn de rayos X de energia E entra al cristal, interactúa con los electrones de este último, primordialmente a travès del efecto fotoeléctrico, para depositar su energia en forma de ionización. Como resultado de la ionización, estados excitados son formados en el cristal. Cuando estos estados decaen, un centelleo o pulso de luz es emitido. La intensidad de centelleo es proporcional a la energia E de los rayos X y decae exponencialmente con una constante de tiempo de 200 ns (Knoll G.F., 1979).

Cuando esta luz incide en el fotocàtodo causa la emisión de fotoelectrones. El número de fotoelectrones emitidos es proporcional a la intensidad de la luz. Cada electrón emitido por el fotocàtodo es atraido al primor dinodo, produciendo a su vez la emisión de varios electrones. Estos electrones secundarios son atraidos al segundo dinodo, donde el proceso de multiplicación es repetido. Como se muestra en la Figura 2.1, una serie de dinodos estàn colocados entre el fotacàtodo y el ànodo del tubo; con cada dinodo hay un aumento succesivo de voltaje.

La corriente final que llega al ànodo es entonces una replica del pulso de corriente que entrò al fotocàtodo, pero es amplificado por un factor que varia entre 10^5 y 10^8 .

La resolución del detector de NaI(Tl) es pobre, debido a las ineficiencias en los procesos que convierten la energía de los rayos X en una señal eléctrica.

La resolución en energia Γ , es decir, el ancho a media altura del pico (Full Width at Half Maximum-FWHM), esta dada por:

 $\Gamma = K(E)^{\frac{1}{2}} \qquad (K=cte)$

Esta resolución es medida por acumulación de cuentas en un pico del espectro de energía, midiendo el ancho del pico a la mitad de su màxima intensidad. Para un buen contador, K puede



FIGURA 2.1 DIAGRAMA ESQUEMATICO DE UN DETECTOR DE CENTELLEO. (Price W.J.,1964; Knoll G.F.,1979)

ser tan bajo como 2.46 en unidades de (Kev)⁵.

Tiempo de respuesta.

Generalmente, la particula cargada atravieza al cristal de centelleo en un tiempo muy corto (del orden de 10^{-10} segun-dos), dejando àtomos o moléculas excitadas en su trayectoria, las cuales al desexcitarse emitiràn fotones. Esta desexcitación no se realiza instantàneamente en todos los àtomos o moléculas, y la intensidad luminosa total, emitida tras el paso de la particula, decae exponencialmente como (Knoll G. F., 1979):

والاستعاط فتريشتهم بالمعد ويوجد والمنج بنبخ للاه

$I/I_0 = f(t) \exp(-t/t)$

Donde I_o es la intensidad luminosa alcanzada tras el paso de la partícula, I es la intensidad luminosa al tiempo t y T es la constante de tiempo, que es una propiedad importante del material centellador. f(t) es una función Gaussiana caracterizada por una desviación estandar. La constante de tiempo 🖝 para cristales inorgànicos (i.e., NaI) es del orden de 10^{-6} segundos.

La Figura 2.2 (Jenkins R., 1981) ilustra la eficiencia del detector de NaI(T1) para el pico de energia màxima. A bajas energías los rayos X son absorbidos en la entrada de la ventana (127 بس de berilio màs 1 بس de aluminio) y la eficiencia es baja. A muy altas energias el cristal es pràcticamente transparente a los rayos X y la eficiencia de detección es reducida. El detector de NaI(Tl) es ùtil para energias en el intervalo entre 6 Kev y 50 Kev.

II.2 Detector proporcional.

Los tipos más antiquos de detectores de radiación nuclear son, la càmara de ionización, el contador proporcional y el tubo Geiger-Muller, cada uno de estos detectores emplea una càmara llena de gas.

El detector proporcional consiste de un cilindro operado a un potencial base, con alambre coaxial en el centro. El alambre està separado del cilindro y operado a un voltaje positivo alto (1000 a 3000 V). El detector està lleno de gas a temperatura y presión controlada.

Un fotòn de rayos X de energía E entra al detector a través de la ventana e interactúa con el gas via procesos fotoeléctricos para producir una nube de ionización. El número promedio de iones producidos està dado por:

$$n = E/c ...(2)$$

Donde E es la energia promedio requerida para producir un ion.



Los valores de ε estàn en el intervalo de 20 a 28 ev dependiendo del gas usado.

Para una mezcia tipica de 90% argòn y 10% metano, $\mathbf{C} \sim 27$ ev. El número de parejas ion-electròn colectadas en el detector depende del voltaje aplicado, como se muestra en la Figu- ra 2.3. En voltaje inicial V₁ se utiliza para colectar las parejas ion-electròn antes de que ellas se recombinen. La càmara de ionización opera a un voltaje superior a V₁. Aqui el voltaje aplicado causa el movimiento de los electrones hacia el alambre central y el de los iones hacia la pared del cilindro, de manera que el número de parejas ion-electròn colectadas es independiente del voltaje del detector. La ecuación (2) multiplicada por la carga de un electròn define la carga colectada.

Entre los voltajes V_p y V_{1p} de la Figura 2.3 està situada la regiòn proporcional. En esta regiòn el voltaje aplicado es lo suficientemente alto para acelerar los electrones hacia el - alambre central, y producir interacciòn con otros àtomos para causar màs ionizaciòn.

Entonces la señal es amplificada en un proceso parecido al esguema empleado en un fotomultiplicador. La amplitud de la señal resultante es proporcional a la energia del fotòn de rayos X incidente. En el intervalo entre V_p y V_{1p} es donde el contador proporcional es operado normalmente. Arriba de V_{1p} la estricta proporcionalidad es pèrdida; primero en el límite de la regiòn proporcional, donde los rayos X de diferentes energias producen diferentes pulsos altos de salida, y después en la regiòn Geiger, donde todos los rayos X producen los mismos pulsos altos. Arriba de la regiòn Geiger ocurre una descarga continua.

En la región proporcional el número promedio de parejas iónelectrón colectadas està dado por:

n' = An = A E/E

donde A es la ganancia de gas, que consiste en que los electrones de la ionización primaria son acelerados para producir ionización adicional. Los electrones son colectados en el alambre central en un tiempo muy corto, tipicamente del orden de 100 nanosegundos. Los iones positivos toman varios cientos de microsegundos para moverse hacia la pared. Unicamente una porción menor de la señal del contador proporcional resulta de la colección de los electrones.

La porción mayor del pulso de salida es formado por el movimiento de los iones positivos.

La resolución en energía del detector esta definida por:

$$\Gamma = [(2.35\sqrt{\epsilon_{FE}})^{2} + \Gamma_{A}^{2} + \Gamma_{ruido} + \Gamma_{p}^{2}]^{\frac{1}{2}}$$

El primer término corresponde al ensanchamiento debido a la estadistica de ionización. El factor F es una constante empirica que multiplicada por la variancia predicha da la variancia observada experimentalmente, su valor està entre 0.09 a 0.23 dependiendo del gas del detector.

Las fluctaciones estadisticas en la ganancia del gas contribuyen a través del segundo término Γ_A . El ruido electrònico del amplificador està tomado en cuenta en el témino Γ_{ruido} , y el término Γ_p cubre las fluctaciones debidas a variaciones en los paràmetros de diseño del contador sobre las dimensiones del contador. Para los casos donde $\Gamma_{ruido} + \Gamma_A + \Gamma_p$ puede ser despreciable, la resolución de energía esta descrita por:

 $\Gamma = K (E)^{\frac{1}{2}}$

con K=0.35(Kev)^{$\frac{1}{2}$} en un buen detector.

La Figura 2.4 muestra una eficiencia de detección tipica como función de la energia (longitud de onda). La disminución de la eficiencia para longitudes de onda grandes depende de los materiales usados en la ventana y varia dependiendo del diseño de la ventana. Para longitudes de onda pequeñas, la transparencia del detector està determinada por el tipo de gas, la densidad de gas y el espesor del volumen sensitivo.

II.3 Detector de Estado Sòlido.

a. Principios de operación y diseño.

La Figura 2.5 muestra una descripción esquemàtica de un detector de estado sòlido.

El uso de un semiconductor como detector de radiación se basa en la absorción de la radiación en el material y consecuente ionización haciendolo momentàneamente conductor. En los semiconductores, esta ionización es descrita como la creación de un par electròn-"hueco", (el hueco es un sitio en la red que lleva una carga positiva debido a la extracción de un electròn de la banda de valencia). Si se aplica un potencial eléctrico a través del cristal, el caràcter semiconductor propicia una pequeña corriente.

La absorciòn de la radiaciòn ionizante crea una cantidad de carga "libre", la cual idealmente es proporcional a la energia depositada por la particula incidente. Esta carga (electrones y huecos), debido al potencial aplicado, se convierte en un pulso que forma la base de la " detecciòn" cualitativa del evento al medirse la energia de la particula absorbida. La proporcionalidad entre la carga y la energia depositada es la clave de este tipo de anàlisis.

La capacidad de alta resolución del detector semiconductor descansa en la alta precisión estadística en su acción transductora, i.e., la conversión de energía a carga.



Energia (Kev)

FIGURA 2.4 EFICIENCIA DE DETECCION DEL DETECTOR PROPORCIONAL (Jenkins Ron, 1981)

Ventana de berilio

24



FIGURA 2.5 DESCRIPCION ESQUEMATICA DEL DETECTOR DE ESTADO SOLIDO.

Si la energia requerida para la creación de un par= electrónhueco es pequeña (ancho de la banda prohibida E_d Ælel cristal), se formaràn un gran nùmero de pares electròn-hucco como re- sultado de la energia depositada, produciendo uma excelente definición estadistica del "tamaño" del pulso de carga. Sin embargo, la energía del ancho de banda E_{α} no $\overline{c_{\alpha}}$ be ser muy pequeña, ya cue la excitación térmica de electrones a través del ancho de banda constantemente crearà pares electròn-hueco (conductividad "intrinseca"). Otro requeriminto importante es que el material de base debe ser muy puro; aunque su conductividad se incrementa mediante la introduccición controlada de ciertos tipos de àtomos como impurezas que crean portadores de carga libre y producen una corriente dese fuga. Las impurezas también crean las llamadas "trampas" " teniendo la capacidad de atrapar cargas y esto causa pérdioda de señal y posible polarización. Esto puede dañar la capacidad de resolución del detector causando dobles pulsos o "coolas" en el espectro. Es por esto que debe tenerse un control muy estricto en el tipo y la densidad de impurezas. Finalmernte, la propiedad de absorción general del material semicondu uctor debe ser lo màs pronunciada posible para hacer un deteo ctor efi- ciente. Sòlo dos materiales semiconductores cumple en en la pràctica con estos paràmetros: silicio y germanio -,

Silicio y Germanio.

La producción de silicio y germanio de suficiente = alta pureza para producir un buen semiconductor intrinseco • (conductividad ùnicamente por excitación térmica) es muyd lificil. Cantidades relativamente pequeñas de ciertas impu arezas tienen el efecto de incrementar la conductividad al punt lo donde las propiedades deseables son anuladas. las impurezas = pueden combinarse en la red cristalina para producir un exc =e so de electrones libres o huecos como portadores de carga e extrinseca -(conductividad por portadores de carga creadas poor impurezas). El silicio de alta calidad es generalmente de tipoo p, esto significa que contiene un exceso de portadores des carga positiva (huecos). Esto puede ser remediado por la instroducción de impurezas en la red cristalina, que neutralicenan o compensen eficàzmente las impurezas primarias. Por ejemplo, - la introducciòn de àtomos de Litio en el cristal (para ambosza, Silicio y Germanio) compensaràn las impurezas y crearàn mt_erial intrinseco con alta resistividad. Tales detectores se Alenotan como Si(Li) y Ge(Li) respectivamente, para indicar (ne estan compensados con Litio.

El enfriamiento del detector es necesario para mæntener la compensación del Litio, evitar efectos de difusiôn, y eliminar el ruido electrònico. Los detectores son enfraiados entonces constantemente a la temperatura del Nitrògenco liquido -(77 K ò -196° C).

b. Resolución del Detector.

Solo una parte de la energia depositada por una particula es utilizada para la creación de pares electrón-hueco; otra parte de la energia es usada en otros procesos de excitación en la red cristalina, como la generación de calor. La energia de la banda prohibida del Silicio es de ~1.1 ev, pero debido a estos otros procesos compitiendo por la energia, la energia promedio E necesaria para la creación del par electrón-hueco es del orden de 3.8-3.9 ev a la temperatura de operación de 77 K . En el caso del Germanio estas energias corresponden a 0.67 ev y 2.98 ev . En vista de la pequeña energia de la banda prohibida y la energia efectiva por par en el Germanio, puede suponerse que este exhibe mejor resolución que el Silicio.

n 1995 - Angel Ang Angel Ang

La resolución en energía FWHM del detector esta definida por (Woldseth R., 1973):

> FWHM = 2.35 (FEE) ev ,

donde: E= energia en Kev \mathcal{E} = ev/par electròn-hueco F= factor Fano (adimensional)

Para el Silicio F esta en el intervalo de 0.10-0.13 y para el Germanio F ~0.13.

La resolución efectiva del sistema detector no puede ser separado de los efectos de ruido electrônico. Esto involucra al amplificador como una componente muy importante. Incorporando la contribución de ruido electrónico, la resoluciòn total puede expresarse como :

FWHM (ev) = $[(FWHM)_{11}^{2} \frac{1}{60} (2.35 \sqrt{FEE})^{2}]^{\frac{1}{2}}$

c. Eficiencia de Detección .

Para un tipo de detector (Ge o Si), la eficiencia de detec- ciòn total esta determinada por varios factores como el àrea y el espesor de la región activa, la "capa muerta" y el material de contacto, y la entrada de la ventana. A bajas energias, los efectos de absorción a la entrada de la

ventana de berilio son dominantes. Los efectos adicionales en esta región son debidos al material de la capa muerta (región cerca de la superficie del detector).

Para energias altas, la eficiencia del pico de "energia màxima" es función del espesor del volumen activo.

El detector de Ge(Li) es utilizado casi exclusivamente para energias arriba de 100 Kev , y el detector de Si(Li) para energias entre 2 Kev a 60 Kev .

En 1975 el detector de Ge(Li) fué reemplazado por un mejor diseño: el detector de Germanio hiperpuro, esta construcción del detector de Germanio es producido sin la compensación del Litio y es utilizado para energias entre 3 Kev y 2 Mev (Manual Ortec, 1985).

27

II.4 Sistema de Excitación.

Según la naturaleza del problema analítico se debe escoger la mejor forma de energía de excitación. dada la composición del espècimen y los elementos de interés presentes, se deben considerar varios factores como la eficiencia òptima de excitación, la línea de interferencia màs adecuada, el traslape minimo de los picos, los efectos de matriz, etc. Idealmente, cada elemento debe ser analizado vía una línea(s) de emisión con problemas minimos de interferencia, eficiencia de fluorescencia òptima y màximo rendimiento de fluorescencia. La producción de rayos X secundarios característicos puede ser llevada a cabo por medio de excitación con fotones (efecto fotoeléctrico), con particulas cargadas, o con una combinación de ambos. Los diferentes sistemas de excitación se clasifican en: excitación por radioisótopos, excitación por tubos de rayos X y excitación por partículas cargadas.

a. Excitación por Radioisòtopos.

Gran número de isòtopos radiactivos decaen con emisión asociada de fotones. Estos pueden ser de origen nuclear (rayos gamma) o ser rayos X característicos generados en las òrbitas electrònicas de los àtomos del material radiactivo como un proceso secundario del decaimiento radiactivo, esto no causa ningún problema en la generación de rayos X desde una muestra puesto que no hay diferencia entre fotones de origen nuclear y de origen atòmico.

El uso de radioisòtopos para excitación tiene la ventaja de que combina simplicidad, exactitud y estabilidad. La emisión primaria de un fotón por decaimiento radioactivo es monoenergética, lo cual puede ser una ventaja o una desventaja, hay que tener en cuenta varios factores.Primero, la emisión debe ser tan simple como sea posible, con una sola emisión gamma o de rayos X caracteristicos en la región de interés. Los radioisòtopos con productos de decaimiento estables son preferibles. Un patròn con emisión compleja puede complicar el anàlisis de dos maneras: La presencia de una energía gamma muy alta puede causar un fondo indeseable en la región de interés debido al escape compton del detector y segundo, las lineas multiples de emisión en el intervalo de aplicación causan problemas de interferencia. Es por esto que para tener una eficiencia de fluorescencia òptima no es conveniente usar una fuente con lineas de emisión que cubran todo el intervalo de interés.

Para obtener mayor flexibilidad y lograr cubrir todo el intervalo, es más conveniente utilizar varios radioisòtopos separados con lineas individuales de emisión. La Tabla II.l lista los radioisòtopos más frecuentemente usados en fluorescencia de rayos X. La "vida media" debe ser razonablemente grande, debido al decrecimiento de la intensidad y a las consideraciones pràcticas de "recalibración" en situaciones de anàlisis cuantitativos. La Figura 2.6 muestra una curva de corrección para un decaimiento universal, con la fracción de actividad inicial expresada como una función del número de "vidas medias" medidas desde la actividad "inicial".

b. Excitación por medio de Tubos de Rayos X.

El tubo de rayos X es una fuente bremsstrahlung de fotones producida por el impacto de electrones acelerados sobre un blanco metàlico (ànodo). Por lo tanto, su salida es un espectro continuo de fotones, el cual es determinado bàsicamente por el material del ànodo del tubo (de nùmero àtomico Z), el voltaje de operación V y la corriente de electrones incidentes. Los electrones emitidos desde un filamento caliente son acelerados hacia el blanco por una diferencia de potencial de hasta 50 Kev, y cuando ellos chocan con el blanco generan ademàs de radiación bremsstrahlung, fluorescencia de rayos X de los elementos presentes en el ànodo. El espectro continuo es débido a la desaceleración ràpida de los electrones que chocan con el blanco, ya que la desaceleración de una partícula cargada emite energia (radiación bremsstrahlung).

La intensidad de la radiación bremsstrahlung es una función de la energía de los electrones (E=eV) y esta dada por:

$I(E) \propto iZ(E_0 - E)E$

donde E_0 es la energia del electròn que alcanza al blanco a un potencial de operación V, y es numèricamente igual a V cuando la energia esta expresada en electròn-volt.

Y la intensidad total sobre todo el espectro continuo por:

Itot~ iZVm

donde m es aproximadamente igual a dos.

Si uno està interesado en excitar con màxima eficiencia un elemento particular en el blanco, el voltaje del tubo podria ser ajustado de tal forma que el màximo de esta distribución de energia este justo arriba de la energia del borde de absorción K de ese elemento.

La dependencia funcional de la intensidad de los rayos X característicos K producidos en el blanco del tubo està dada por:

TABLA II.1 RADIOISOTOPOS PARA FLUORESCENCIA DE RAYOS X

Nuclido	Vida Media (T½)	Emisión	Producciòn Teòrica % (por desintegraciòn	Modos de Decaimiento
Fe 55	2.7 años	5.9 Kev; rayos X: Mn K	26	Captura electrò~ nica
Cd 109	453 dias	22.1 Kev; rayos X: Ag K 87.7 Kev; gamma	107 4	Captura electrònica
Am 241	458 años	59.57 Kev; gamma (rayos X: Np L) 26.4 Kev; gamma	36 40	Decaimiento alfa
Co 57	270 dias	136 Kev; gamma 122 Kev; gamma 144 Kev; gamma (6.4 Kev; rayos X: Fe K)	11.1 85.2 9.7 51.0	Captura electrònica
Gđ 153	242 dias	103 Kev; gamma 97 Kev; gamma 70 Kev; gamma 41 Kev; rayos X: Eu K	20.0 30.0 2.6 110.0	Captura electrònica
Pu 238	86.4 años	12-17 Kev; rayos X: U L	10	Decaimiento alfa
Fuentes Bren	nsstrahlung:			
Pm 147	2.6 años	Punto final: 225 Kev		Decaimiento beta
H3 (Tritio)	12.26 años	Punto final: 18.6 Kev		



Número de vidas medias

FIGURA 2.6 CORRECCION DEL DECAIMIENTO "UNIVERSAL", EXPRESANDO LA FRACCION REMANENTE DE ACTIVIDAD INICIAL COMO UNA FUNCION DEL NUMERO DE VIDAS MEDIAS DESDE EL TIEMPO "CERO" (ACTIVIDAD INICIAL). LAS ESCALAS DEL LADO DE RECHO Y PARTE SUPERIOR SON UNA EXPANSION PARA EL

INTERVALO: 0-1 DE "VIDA MEDIA". (Woldseth Roff, 1973).

зο

$I_{K} \simeq [(E_{0}/E_{K})-1]^{1.67}$

donde E_K es la energia de amarre del electròn-K y, E_o es la energia de excitación, mayor que E_K.

La exposición de la muestra a la radiación bremsstrahlung de un tubo de rayos X permite excitar sólo aquellos elementos en la muestra con energías de amarre menores que la energía de excitación.

Para mejorar la sensitividad (reduciendo el fondo), un haz de rayos X monoenergético puede ser usado para excitar a la muestra. En principio hay tres formas de obtener radiación monoenergética desde un tubo de rayos X: una es pasar la radiación del tubo a través de filtros. La segunda, es usar los rayos X del tubo para excitar un blanco de algún metal puro y entonces producir radiación secundaria monoenergética, como se muestra en la Figura 2.7. La tercera es difractar sobre planos cristalinos específicos de un monocristal la radiación proveniente del tubo, antes de hacerla incidir sobre la muestra. La difracción en el monocristal (monocromador) solo es posible para una longitud de onda partícular, por lo que la radiación resultante es monoenergética.

c. Sistemas de Excitación por particulas cargadas.

La estimulación de la emisión de rayos X característicos con partículas cargadas pesadas ofrece una alternativa de detección de elementos con números àtomicos pequeños (Z414) presentes en la muestra, ya que la sección eficaz de ionización crece fuertemente cuando decrese Z. Ademàs, la producción de bremsstrahlung de las partículas cargadas es relativamente pequeña comparada con los electrones.

Particulas alfa y protones de alta energia pueden ser producidos por aceleradores, tales como ciclotrones, Van de Graaff y aceleradores Cockroft-Walton. El costo y complejidad de estos equipos limitan claramente su incorporación en el diseño de un instrumento analítico "estandar".

Ahora bien, la aplicación de sistemas de rayos X de fluorescencia en conjunción con microscopios electrònicos de barrido (SEM), microscopios electrònicos de transmisión (TEM), ò microsondas electrònicas (MP) dan información sobre la composición quimica, detalles topogràficos, y estructura del espécimen a través de un nùmero de procesos de interacciones primarias y secundarias (canales de información); i.e., dispersión de electrones, en reflexión y transmisión, electrones secundarios, electrones Auger, luminiscencia catòdica, rayos X característicos, difracción de rayos X, etc. La imàgen es obtenida en un tubo de rayos catòdicos o monitor, con el barrido del haz de electrones y con la señal de uno de los canales de información.


FIGURA 2.7 REPRESENTACION ESQUEMATICA DE EXCITACION POR TUBO DE RAYOS-X EN BLANCO DIRECTO Y SECUNDA-RIO. (Woldseth R., 1973).

CAPITULO.III ANALISIS EXPERIMENTAL

III.1 Introducción.

En México como uno de los primeros productores de plata en el mundo, existen en el mercado piezas ornamentales con alta concentración de plata (70% a 100%) y baja concentración de cobre para darle dureza al material, por ejemplo, cubiertos de mesa, vasijas, joyeria, etcètera. Por eso, es de interés comercial e industrial el poder contar con un sistema de anàlisis espectrométrico, eficiente, de bajo costo, rapido, y no destructivo de dichas piezas de plateria.

Es bien sabido que el costo de un sistema completo de rayos X de fluorescencia usando un detector semiconductor, más un multicanal màs la electrònica asociada es bastante alto. Sin embargo, el costo de un sistema de detección basado en un detector de centelleo y un contador integral es sumamente bajo. En este trabajo se diseña un sistema de anàlisis químico elemental por fluorescencia de rayos X, eficiente, de fàcil mànejo, y de bajo costo. Este sistema utiliza un detector de centelleo de 1 mm de espesor, un contador integral, filtros balanceados y rayos gamma como radiación primaria.

Este Capitulo se presenta en dos partes, en la primera parte se utiliza un sistema con detector de Germanio hiperpuro, para comparar los resultados obtenidos con el sistema diseñado. Se describen los procedimientos experimentales para obtener la eficiencia del sistema, y el anàlisis por fluorescencia de ravos X.

En la segunda parte se describe el diseño de un sistema espectrométrico que usa rayos gamma como radiación primaria y rayos X fluorescentes como radiación secundaria. La radiación secundaria es analizada con filtros balanceados y registrada con un detector de centelleo de 1 mm de espesor y un contador integral. Se muestran los procedimientos experimentales para obtener los niveles adecuados de umbral del discriminador, y las curvas de discriminación de la energía empleando filtros balanceados.

III.2 Sistema con Detector de Germanio Hiperpuro.

Un sistema interesante que permite el anàlisis con fuentes radioactivas es el que involucra un detector de estado sòlido, electrònica asociada de alta calidad, y un analizador multicanal; lo que por supuesto incrementa el costo del sistema con respecto al de filtros balanceados.

34

Un aspecto importante en el anàlisis experimental con este sistema consiste en determinar la recta de calibración del detector. Para esto se empleò, en transmisión directa al detector, una fuente puntual de Am-241 con energías de emisión de: 59.57 Kev, 26.36 Kev, 20.77 Kev, 17.74 Kev, y 13.95 Kev.

El procedimiento experimental consistiò en lo siguiente: primero se obtuvò el espectro de los rayos X emitidos por la fuente de Am-241. En la Figura III.l se muestra dicho espectro, donde se señala la energia de emisión de cada pico.

A continuación se graficò las energias de emisión de la fuente de Am-241 en función del número de canal en el analizador multicanal, para obtener la recta de calibración del detector, dicha recta se muestra en la misma figura.

Otro aspecto importante en este tipo de sistemas es la necesidad de conocer la eficiencia del sistema, lo que describimos a continuación.

a. Eficiencia del Sistema.

La eficiencia del sistema relaciona el número de pulsos del detector al número de rayos gamma (-5) emitidos por la fuente. Un conjunto de fuentes puntuales calibradas es requerida para calcular la eficiencia del sistema en función de la energía.

Las fuentes gamma de calibración utilizadas se muestran en la Tabla I.



FIGURA III.1 ESPECTRO DE LOS RAYOS X EMITIDOS POR EL Am-241, Y RECTA DE CALIBRACION DEL DETECTOR DE GERMANIO HIPERPURO.

ω S

				30
			i da la filipio del del programa del como del secono de sil. Non del programma del control del constituis contro del conservativo del secono del secono del secono del secon	
	the first sector is a statistical sector. The sector se		Constraints and a second and a second	
andari senara dangang. Tanggang	lan serie yn rederiodd yn a'r ar yn ar	TABLA I	an a	
		가 이 방지 않는 것 것 같다. 같은 방법은 말 수 있는 것 같은 것 같이.		
	Actividad		상품에는 사망에 있는 것으로 가지 않는다. 1993년 - 1993년 -	Actividad
	Inicial	Vida	Constante de	Real
	Ao(سCi)	Media	Decaimiento	A(MCi)
Fuente	t _o = 1/dic/85	Ty(dias)	(dìas) ⁻¹	11/jun/86
			4848 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11	- 2013년 1973년 1973년 - 1973년 1973년 1973년 1973년 197
Am-241	11.62	167,170	4.15x10 ^b	11.62
Ba-133	11.79	2,628	2.64x10 ⁴	11.20
Cs-137	11.85	10,950	6.33x10 ⁵	11.71
Co-60	11.37	1919.90	3.61x10 ⁴	10.60
Y-88	12.35	108	0.01	1.77
Na-22	11.57	956.30	7.25x10 ⁴	10.05
Mn-54	11.58	303	2.29x10 ³	7.43
Hg-203	23.32	46.9	0.01	3.35
Co-57	11.72	270	2.57x10 ³	7.12
Eu-152	10.00	4635.50	1.49x10 ⁴	9.72
	the second s	the second states were an and the second states and the second states to be a second state with the second states and second states	the state of the second st	

La actividad real està dada por la relaciòn:

 $A=A_0 \exp(-\lambda t)$

donde:

t: son los dias transcurridos entre la fecha de calibración de la fuente 1/dic/85 y la fecha del càlculo de la eficiencia del sistema 11/jun/86, es decir, t=194 dias.

Por lo tanto, la actividad real A para cada fuente se obtiene de la relación:

$A=A_0 \exp(-194\lambda)$

donde la constante de decaimiento $\lambda(dias)^{-1}$ esta expresada por:

λ=Ln 2/T₁

Los resultados obtenidos en el càlculo de la eficiencia del sistema se muestran en la Tabla II, donde la intensidad efectiva I en cuentas por segundo (cps) se obtuvo restandole el fondo al àrea neta de cada pico.

La actividad A de cada fuente calibrada se calculò en términos de desintegraciones por segundo (dps), donde 1 µCi=3.7x10⁴ dps.

La actividad A1 en términos de rayos gamma por segundo (1/s) se obtuvo multiplicando la actividad A(dps) de cada fuente calibrada por la fracción de rayos gamma por decaimiento f(*/dec). Por consiguiente, la eficiencia del sistema en términos de cuentas por rayo gamma (cts/r) es la razón de la intensidad I(cps) entre la actividad $A_1(r/s)$, es decir,

			TABLA II		영화 영화 관계 관계	행동 영화 가격을 받	
Fuente	Energia de los rayos -3 E ₃ (Mev)	Fracción de rayos-Y por decaimiento f(Y/dec)	Vida media T 1/2	Intensidad I (cps)	Actividad A (dps)	Actividad A ₁ (۶/s)	Eficiencia del Sistema (cts/~)
	0.014	.084		118		22 129	5.3 X 10
Co-57	0.122	.87	270	1 113	263 440	229 193	4.9 X 10
	0.136	.11	días	119		28 978	4.1 X 10
	0.026	.026		76		11 180	6.8 X 10
Am-241	0.033	.002	'458	35	430 000	860	4.1 X 10
*****	0.060	.36	años	1 017		154 800	6.6 X 10
	0.052	0105				8 081	6 0 X 10
Pa 199	0.000	.0192		1 102	414 400	0 001	7 4 2 10
DA~133	0.356	.30 .67	años	1 103 514	414 400	277 648	1.9 X 10
	0 1 0 0	222		600		110 500	F 1 V 10
	0.122	.332		609	an a	119 520	5.1 A 10
	0.245	.072	가지 않는 것이다. 1998년 - 1998년 - 1997년	42		25 920	1.6 X 10
Fu 160	0.344	•31	+0 7	00	360.000	111 600	5.8 X 10
50-192	0.719	•004	12.1	0	300 000	1 440	5.5 × 10
	0.904	.1/3	anos	4	la de la constante de la const Constante de la constante de la	2 200	0.4 X 10
	1,000	.100		3	영상 성장은 것이 같아요.	50 000	6 9 8 10
	1.458	.104		4		2 160	1.9 X 10
	an an an ann an Arland ann an Arland. Ar Arland Arland an Arland an Arland an Arland an Arland an Arland an Arl Ar Arland an Arland a		2002 ESE		의 소가 있다. 1989년 - 일이 가지 않는 것이다. 1989년 - 전 전 가지 않는 것이다.		
Hg-203	0.279	.77	días	36	124 000	95 480	3.7 X 10
			202				-
Mn-54	0.835	1.00	días	28	275 000	275 000	1.4 X 10
			20				
Cs-137	0.662D	.86	años	52	433 270	372 612	1.4 X 10
	1 17	1.00	F 00	01		202.000	r
Co-60	1 22	1.00	0.40	C1 17	207 200	392 200	2.3 X 10
	1.00	T.00	diivə		392 200	392 200	4.3 A IU
	1.275	1.00	2.62	- 21		371 850	5.6 X 10
va-22	0.511A	1.80	años	190	371 850	669 330	2.8 X 10
	1.836	1.00	108	4		65 500	6.1 X 10
Y-88	0.848	.92	días	12	65 500	60 260	2 X 10

Eficiencia del Sistema (cts/ʒ)=I/A1

in and a sum in a summittee when its summittee

Ahora bien, la eficiencia del sistema en cuentas por rayo gamma (cts/★) en funciòn de la energìa de excitaciòn E(Kev) se muestra en la Figura III.2.

Una vez obtenida la eficiencia del sistema se procediò a hacer un anàlisis con muestras estandar de plata màs cobre.

b. Anàlisis de Rayos X de Fluorescencia

Se utilizò el sistema con detector de Germanio hiperpuro, para comparar los resultados obtenidos con el sistema diseñado de rayos X de fluorescencia con detector de centelleo, empleando las mismas muestras estandar de plata màs cobre.

El montaje experimental y el diagrama de bloques para este sistema se muestra en la Figura III.3. La fuente que se empleò fué una puntual de Am-241 (con una vida

media de 458 años y una actividad de 60 mCi) con un recubrimiento de acero inoxidable; con energias de emisión gamma de 59.57 Kev sin las demàs energias, ya que el acero inoxidable las filtra. Se utilizaron muestras estandar de plata màs cobre, con altas concentraciones de plata (70% a 95%).

En la Figura III.4 se muestra el espectro de la aleación estandar Ag+Cu, con una concentración de 70% de Ag. Los resultados obtenidos son mostrados en la Tabla III.

TABLA III

Concentraciòn de plata (%Ag)	Intensidad (cpm)
70+0.20	21 720
75+0.37	31,720
8010 58	35,030
80 <u>+</u> 0.50	37,300
85±0.26	41,100
90 <u>+</u> 0.12	43,450
95±0.09	46.530

Utilizando estos resultados se graficò la concentración de plata de la muestra (%Ag) en función de la intensidad en kilocuentas por minuto (Kcpm), dicha curva se muestra en la Figura III.5.

Una vez obtenida esta curva, podemos determinar el contenido de plata en cualquier muestra con alta concentración de plata.

Para ampliar nuestro anàlisis de rayos X de fluorescencia, a continuación se desarrolla el procedimiento experimental utilizado.

Para la preparación de las muestras se utilizó un molde circu-





FIGURA III. 3 REPRESENTACION ESQUEMATICA DEL ARREGLO GEOMETRICO: DETECTOR-MUESTRA-FUENTE. Y DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SISTEMA.





lar (de diàmetro 3 cm y espesor de 3 mm), dos mecheros Bunsen, un agitador, y un tripie. El plomo y el elemento de interés colocados en el molde se

fundian a dos fuegos utilizando los mecheros Bunsen, uno en la parte superior y el otro en la parte inferior del tripie, se agitaba constantemente la muestra para obtener una aleación homogenea.

Se hicieron 10 muestras:

4 aleaciones de Plomo-Indio (Pb-In), 6 aleaciones de Plomo-Cadmio (Pb-Cd).

En cada serie las muestras tienen diferente concentración. Ahora bien, utilizando estas muestras se obtuvo la intensidad de los rayos X de fluorescencia en cuentas por minuto (cpm), restandole el fondo a cada intensidad. Los resultados obtenidos para las muestras Plomo-Indio (Pb-In) se muestran en la Tabla IV.

Concentr de la mu %Pb	aciòn estra %In	Nùmero de los canales extremos	Intensidad (cpm)	Integral (àrea bajo la curva)	Intensidad efectiva I _{ef} (cpm)
92	8	234 250	276 205	7,339	3,491
96	4	234 250	273 778	4,854	1,646
99	1	248 186	248 186	4,065	593
99.5	0.5	234 250	280 192	3,563	45

TABLA I V

Para demostrar el procedimiento utilizado en obtener la intensidad efectiva I_{ef} (àrea total menos el fondo),se da el si-guiente ejemplo:

Para la concentración 8% de In:



donde el àrea total bajo la curva esta denotada por:

$$A_T = A_1 + A_2 + A_3$$

y el fondo por las àreas A2 y A3.

El càlculo del fondo se obtiene de la manera siguiente:

$$A_{2} = \frac{(276 - 205)(250 - 234)}{2} = 568$$
$$A_{3} = (250 - 234)(205) = 3,280$$

Por lo tanto, el fondo es:

Si el àrea total (integral) $A_{\rm T}{=}7,339$ entonces la intensidad efectiva $I_{\rm ef}$ es:

 $I_{ef} = A_T - (A_2 + A_3)$

Es decir,

I_{ef}=7,339-3,848

Por lo tanto,

Este mismo procedimiento se utilizò para las aleaciones restan-

tes. Ahora bien, la Figura III. 6 relaciona la intensidad efectiva en función de la concentración de Indio $(I_{ef} vs \% In)$ determinada por la relación lineal (minimos cuadrados):

I_{ef}(cpm)=438.2(%In)-35.0

Su coeficiente de correlación lineal es:

r=0.996

Una vez obtenida esta curva y su relación lineal, podemos determinar el contenido de Indio en cualquier muestra.

Los resultados obtenidos con las aleaciones de Plomo-Cadmio (Pb-Cd) se muestran en la Tabla V.

TABLA V

Concei	ntraciòn	Intensidad
de la	muestra	Efectiva
%Pb	%Cd	I _{ef} (cpm)
85	15	1,692
90	10	1,682
92	8	1,150
94	6	857
96	4	238
98	2	162

Estos resultados estàn representados por la Figura III.7 $(I_{ef} vs \% Cd)$.

Su regresión lineal està dada por:

$$I_{ef}(cpm) = 134.5(\% Cd) - 45.4$$

Con coeficiente de correlación lineal:

r = 0.927

Una vez obtenida esta curva y su relación lineal, podemos determinar el contenido de cadmio en cualquier muestra.





III.3 Sistema con Detector de Centelleo de 3.8 cm x 0.1 cm y Equipo Integrado (Mini Scaler, modelo MS-2, Eberline)

La plata emite rayos X (K) de fluorescencia de las siguientes energias:

Ασ Κ	E(Kev)	T I	tensid	ad
		Re	elativa	(%)
Ker1	22.159)	100	
K_2	21.938	3	50	
Kp1	24.938	3	15-30	
K o2	25.452	?	1-10	

Por consiguiente, para aislar los rayos X de fluorescencia Kal, los filtros adecuados son los de rutenio (Ru) y rhodio (Rh), y para aislar los rayos X de fluorescencia K_{p1} y K_{p2} los filtros adecuados son los de paladio (Pd) y plata (Ag). En la Figura III.8, se muestran los filtros indicando sus bordes de absorción K y los rayos X de fluorescencia K_{es} y K_{es} de la plata.

Ahora bien, el tecnecio (Tc) no se encuentra en la naturaleza, ya que es un producto derivado de la fisión del uranio. Y el filtro de rutenio es muy dificil de conseguir.

El montaje experimental fué el siguiente: Detector-Filtro-Muestra-Fuente, el cual se muestra en la Figura III.9. El arreglo geométrico de este sistema es el mismo que el sistema con detector de Germanio hiperpuro.

La fuente que se empleò fué la misma que se utilizò en el sistema con Germanio hiperpuro, una fuente puntual de Am-241 con energias de emisión gamma de 59.57 Kev. Se utilizaron las mismas muestras estandar de plata más cobre, con altas concentraciones de plata (70% a 95%).

Los pares de filtros utilizados fueron: molibdeno y rhodio, paladio y plata; tal que se pudieran comparar los resultados usando las K_{e's} y las K_{e's} de la plata.

a. Nivel de Umbral del Discriminador.

Para contar los pulsos adecuadamente es necesario convertir los pulsos analògicos a pulsos digitales. El discriminador es el aparato más sencillo para este tipo de conversión y consiste en un circuito que produce una salida digital solo si la amplitud del pulso analògico de entrada està contenido en la ventana elegida y excede un nivel de umbral de discriminación. Si la amplitud del pulso de entrada es menor que el umbral, no habrà pulso de salida (H. Arreola S. et al, 1983); este umbral es el que controla el nivel de la ventana.



ENERGIA DE LOS RAYOS X (Kev)

FIGURA III.8 REPRESENTACION ESQUEMATICA DE LOS FILTROS EMPLEADOS EN EL ANALISIS DE LA PLATA, INDICANDO SUS BORDES DE ABSORCION K, Y LOS RAYOS X DE FLUORESCENCIA K $_{\rm MS}$ K $_{\rm MS}$ DE LA PLATA.



Primero se determinò el voltaje òptimo de operación del detector utilizando el arreglo experimental antes mencionado, la muestra estandar con 95% de plata, y el discriminador con un nivel de umbral de 0.5 V, y sin ventana.

El procedimiento consistiò en lo siguiente: se tomaròn lecturas de nùmero de cuentas, señal (S), en cuentas por minuto -(cpm) contra alto voltaje (HV) en volts, aumentando el alto voltaje de O V a 1,100 V. A continuación se retirò la fuente de Am-241, y se tomaròn lecturas de nùmero de cuentas, fondo (f), contra alto voltaje, disminuyendo el alto voltaje hasta O V. Con estos resultados se graficò $(S-f)^2/f$ vs HV, obteniendose una curva con un màximo, este màximo corresponde al alto voltaje òptimo de operación, es decir, la relación señal a ruido òptima. El voltaje determinado fué de 900 V.

Ahora bien, para obtener los niveles adecuados de umbral del discriminador para cada uno de los filtros, se obtuvo un promedio de la intensidad en cuentas por minuto (cpm) de diez mediciones realizadas, variando el nivel de umbral de 1.5 V a 6.0 V, con un ancho de ventana de 0.25 V, procurando con esto que todos los pulsos de interés entren en la ventana. Se utilizò la muestra estandar con 95% de plata, para tener alta intensidad de plata y poca interferencia de cobre, y para procurar con esto que la radiación K_{∞} y K_{α} de la plata caigan en los picos del espectro de la muestra estandar. El pico en los espectros de la muestra empleando los filtros de molibdeno y de rhodio respectivamente, corresponderàn a la radiación K_{ec} de la plata. Y el pico en los espectros de la muestra empleando los filtros de paladio y plata respectivamente, corresponderàn a la radiación Ko de la plata. Los resultados obtenidos se listan en la Tabla VI.

Con estos resultados, se graficò la intensidad (cpm) en funciòn del nivel de umbral (V), Figura III.10. Dentro de la ventana que representan los dos filtros existe la posibilidad de que caigan otras K_{x} y K_{p} de otros elementos, sin embargo, en nuestro caso son metales enriguecidos.

El nivel adecuado de umbral de discriminación, corresponde en estas curvas al nivel de umbral para el cual la intensidad es màxima. Los niveles adecuados de umbral se muestran en la Tabla VII.

TABLA VI

Nivel de		Inten Filtr	sidad (cpm) os:		Diferenci Intensida	a de des (cpm)
Umbral (V)	Мо	Rh	Pd	Ag	Mo-Rh	Pd-Ag
1.50	2,337	1,663	529	698	674	169
1.75	1,571	855	157	203	716	46
2.00	2,040	1,148	128	151	892	23
2.25	3,004	1,655	208	272	1,349	64
2.50	4,909	3,031	469	566	1,878	97
2.75	8,286	5,515	1,082	1,146	2,771	64
3.00	13,690	9,709	2,095	2,130	3,981	35
3.25	18,509	15,488	3,312	3,371	3,021	59
3.50	27,428	21,828	4,979	5,773	5,600	794
3.75	32,856	26,751	6,187	7,459	6,105	1,272
4.00	36,489	29,136	6,427	8,675	7,353	2,248
4.12	38,000	29,806	7,131	8,750	8,194	1,619
4.25	37,335	28,930	6,909	9,175	8,405	2,266
4.50	34,759	26,437	6,292	8,738	8,322	2,446
4.75	31,081	22,858	5,511	8,278	8,223	2,767
5.00	26,586	19,802	4,700	7,159	6,784	2,459
5.25	22,450	16,441	3,899	5,679	6,009	1,780
5.50	18,269	13,318	3,268	4,873	4,951	1,605
5.75	14,738	10,754	2,508	4,124	3,984	1,616
6.00	11,726	8,070	2,005	2,869	3,656	864



[1] A. M.	en en la	지 않는 것은 것 같은 것 같은 것 같은 것 같아. 그는 것	
	TABLA VII-	Service Strategy and the	999 M M M M M M M M M M M M M M M M M M
이 가지 않는 것이 같은 것이 같이 있는 것이 같이 많이 했다.		나는 말에 가장하는 말았다.	
소리 리는 그는 것 가장 전 1월 문 4일 수	이 가지 않았다. 방법에 있다.		
	이 있는 것이 가 가슴에서 동안가 전문하게 가	그는 걸어진 승규는 모양 관람은 것은	양성 영화 수상 소망했다.
전 이 것 같은 것	 ab abro8 	Nive	1 Adecua
그는 이 가슴에서 감독했는 것을 못했다.			
이 집에 가지 않는 것 같이 많이	Absorción	K do di	alimbrai
이 가슴, 지수는 것이 것을 같은 것을 받았다.	UPPOLCIOU	() () () () () () () () () () () () () (
Filtro	(Kov)		V 1
		的复数形式 的复数形式的复数形式	20 전문영문 한 유민이
	그렇는 말 눈가 있지? 가지 않는		행정을 걸려 가지 않는
	말 같은 상태, 방법은 문화했다.		
Molibdeno (Mo)	20 002	4 7	Λ
norio (no)	20.002		•
Phodio (Rh)	23 224	1	n
WIGHTO (WILL)		96.00 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•
Paladin (Pd)	74 347	H#F 1 − 1	7
1010010	물건 이 것은 것 같은 것이 같아?	한 옷이 많은 것이라. 이는,	•
Plata (Arr)	25 517	4.7	5
1 1000 (119)			.
 A second s	승규는 이 가장 이 것은 것은 것의 물건물건이 많	- 19 - E G1 - 717 FF	

Ahora bien, la diferencia en intensidad para cada par de filtros adyacentes, es resultado de la diferencia en transmisión entre los dos filtros, es decir, la intensidad en el intervalo de energia de interés. Los resultados de estas diferencias en intensidad para cada par de filtros en función del nivel de umbral se muestran en la Figura III.11.

b. <u>Curva de Discriminación de la Energía con Filtros Balanceados</u>.

Una vez obtenidos los niveles adecuados de umbral, se procediò a obtener las curvas de discriminación de la energía con filtros balanceados. Para esto se utilizaron las mismas muestras estandar de plata más cobre.

El procedimiento experimental consistiò en lo siguiente: Una vez que se han calculado los espesores màsicos de cada par de filtros (Apéndice), se coloca la muestra de interés equivalente para esos filtros con 0% de concentración del elemento y se toman las lecturas de la intensidad (cpm) con esos filtros, y a continuación se reduce la lectura del filtro de mayor número de cuentas con laminillas delgadas de aluminio y polietileno hasta que los dos filtros de cada par, tengan el mismo número de cuentas, garantizando con esto que se tiene 0% de concentración del elemento de interés, a esto es a lo que se llama balanceo de los filtros.

Ahora bien, para obtener las curvas de discriminación de la energía se siguió el procedimiento descrito por Jenkins Ron (Quantitative X Ray Spectrometry, 1981) para filtros balanceados, en este caso para Mo y Rh que son los filtros adecuados para la selección de la K_Q de Ag, y los filtros de Pd y Ag para la selección de la K_Q.

Primero se obtuvo un promedio de la intensidad en cuentas por minuto (cpm) en diez mediciones para cada filtro y para cada valor de la concentración de plata en la muestra estandar.

54

and a second second





អូ

Los resultados obtenidos son mostrados en la Tabla VIII. TABLA VIII

		Intensida	ad (cpm)	
Concentración		Filtros:		
de Plata (%Ag)	Мо	Rh	Pđ	Ag
70	107,569	82,400	19,307	25,454
75	115,600	89,600	21,072	27,454
80	123,650	96,282	22,665	29,529
85	131,048	102,251	24,490	31,698
90	140,200	110,218	26,365	33,918
95	148,277	117,200	28,579	36,454

Utilizando estos resultados se graficò la concentración de plata de la muestra (%Aq) en función de la intensidad en kilocuentas por minuto (Kcpm), para los filtros de rhodio y molibdeno (Figura III.12), y para los filtros de paladio y plata (Figura III.13).

Consecuentemente la diferencia en intensidad para cada par de filtros advacentes, es resultado de la diferencia en transmisiòn entre los dos filtros, es decir, la intensidad en el intervalo de energia de interés. Los resultados de estas diferencias en intensidad se muestran en la Tabla IX.

TABLA IX

Concentraciòn de Plata (%Ag)	Diferencia Par de Mo-Rh	en Intensidad Filtros: Ag-Pd	(cpm)
70	25,269	6,152	
75	26,000	6,552	
80	27,368	6,864	
85	28,797	7,208	
90	29,982	7,553	
95	31,007	7,880	

Ahora bien, tomando estos resultados obtenemos la curva de discriminación de la energía para cada par de filtros, graficando la concentración de plata (%Ag) en función de la diferencia en intensidad (Kcpm). La grafica correspondiente para los filtros de Molibdeno-Rhodio (Mo-Rh) esta representada en la Figura III.14, y para los filtros de Paladio-Plata (Pd-Ag) en la Figura III.15. Estas curvas estan ajustadas por el método de minimos cuadrados.

1 K.

(赤) まごきがみかけい

Law













a sa a sa sa sa sa sa sa

Una vez obtenidas estas curvas podemos determinar el contenido de plata en muestras con alta concentración de plata (70% a 100%). Como se nota de las Figuras III.14 y III.15 no se debe extrapolar a concentraciones menores a 70% ya que para esto es necesario hacer otras curvas de calibración debido a efectos de matriz e ineficiencias de los filtros a diferentes energías.

62

Ahora bien, se muestra en la Figura III.16 las dos curvas anteriores pero graficadas con escalas tales que es posible comparar visualmente su comportamiento relativo. En esta figura se observa que las pendientes de dichas curvas (0.004 %Ag/cpm y 0.015 %Ag/cpm respectivamente) indican que la resolución es mayor en la primera.

Al utilizar Mo y Rh como filtros para aislar los rayos X de fluorescencia K₄ de la plata se obtiene una resolución aproximadamente cuatro veces mayor que cuando se utiliza el sistema con los filtros Pd y Ag para aislar los rayos X de fluorescencia K₆.

Por consiguiente, comparando estas curvas, con la curva obtenida con el sistema de detector de Germanio hiperpuro (Figura III.5), podemos concluir que la resolución del sistema diseñado usando los filtros Mo y Rh es comparable con la resolución del sistema con detector de Germanio hiperpuro, por lo tanto, el sistema diseñado en esta tesis con los filtros Mo-Rh, podria

ser confiablemente usado en sustitución de un sistema con detector de Germanio hiperpuro.

CONCLUSIONES.

63

Es bier, sabido que el costo de un sistema completo de rayos X de flucrescencia usando un detector semiconductor, màs un multicanal, màs la electrònica asociada es bastante alto,alrededor de \$30,000 dòlares, por lo que muchas instituciones no podrian usar estè sistema debido a que no cuentan con los medios para su adquisiciòn. Sin embargo, el costo de un sistema de detección basado en un detector de centelleo y un contador integral es de aproximadamente de \$4,000 dòlares.

Por otro lado, la gran ventaja del detector semiconductor estriba en su alta resolución que es capaz de discriminar entre las líneas K_{α} y K_{α} de un mismo elemento, esto implica necesariamente el uso de multicanales de alta resolución lo que al final constituye un sistema completo de alta resolución. Aunque la resolución de un detector de centelleo de 0.1 cm de espesor es baja, hemos demostrado en estè trabajo que es posible obtener un cociente señal/fondo continuo elevado de este detector usando filtros balanceados en las energías adyacentes a las líneas de interés.

Intrinsecamente el detector de centelleo no puede discriminar entre lineas K_{α} y K_{β} de algunos elementos, con el empleo de filtros balanceados lo estamos transformando a un sistema de mayor resolución. Una ventaja secundaria es el hecho que el detector de centelleo tiene una mayor eficiencia que el detector semiconductor, por lo que se requiere fuentes menos intensas y tiempos de conteo menores. Otra ventaja la representa el hecho de que esté sistema se puede usar de forma portàtil a lugares de dificil acceso.

Las vertajas del "Sistema de Rayos X de Fluorescencia con Detector de Centelleo" descrito en este trabajo son:

-La utilización de un equipo sencillo, de bajo costo y de fàcil manejo.

-El empleo de una fuente de excitación (Am-241) de intensidad relativamente baja (60 mCi), por lo que no existe ningún riesgo de radiación al operario.

-El empleo de filtros balanceados provee discriminación de la energía en forma "no dispersiva".

- -Ademàs de las ventajas ya conocidas del anàlisis por fluorescencia de rayos X: es no destructivo.
- -Los requerimientos para la preparación de la muestra son frecuentemente minimos, y el sistema puede acomodar muestras de una variedad de tamaños, cortes y formas.

Las aplicaciones de està tecnica anàlitica son mùltiples y aumentan en su diversidad, por ejemplo, mediciòn y monitoreo

de contaminantes en nuestro medio ambiente, anàlisis para ayudar el diagnòstico de enfermedades, anàlisis en la medicina forense, anàlisis de materiales para control de calidad en la industria, mediciones del espesor de recubrimientos en materiales, mediciones en la investigación científica, estudio de piezas arqueològicas, detección de falsificaciones en el arte, anàlisis de minerales, y muchas otras aplicaciones importantes en la industria y en la ciencia.

APENDICE

CALCULO Y LISTADO DE FILTROS BALANCEADOS:

Para mostrar el procedimiento utilizado en el càlculo de filtros balanceados, supongamos que se desea aislar los rayos-X de fluorescencia del zinc (K_{N1} =8.638 Kev y K_{N2} =8.615 Kev), se utiliza un par de absorbedores o filtros de cobre (Cu) y niquel (Ni) cada uno con un espesor tal que los productos:

 $\mathcal{L}_{Cu} \cdot (S \cdot m) , y$ $\mathcal{L}_{Ni} \cdot (S \cdot m) ,$

tengan el mismo valor excepto para energias comprendidas entre 8.331 Kev y 8.980 Kev, determinadas por los bordes de absorción del niquel y cobre respectivamente. Donde S es la densidad en gramos por centimetro cúbico (g/cm³), m es el espesor en centimetros (cm), y $/_{Cu}$, y $/_{N_1}$ son los coeficientes de atenuación màsica del cobre y del nicuel respectivamente en centimetros cuadrados por gramo (cm²/g).

Partiendo de lo anterior, sean:

 $I_{Cu}=I_{O}\cdot \exp[-\mathcal{P}_{Cu}\cdot(S\cdot m)_{Cu}]$, y

 $I_{N_i} = I_0 \cdot exp[-N_i \cdot (S \cdot m)_{N_i}]$,

donde Io es la intensidad inicial.

Si los filtros estàn balanceados, es decir,

I_{Cu}=I_{Ni}

entonces,

$$\mathcal{M}_{Ni} \cdot (S \cdot m)_{Ni} = \mathcal{M}_{Cu} \cdot (S \cdot m)_{Cu}$$

 $(\mathcal{M}_{Ni}/\mathcal{M}_{Cu})(s \cdot m)_{Ni} = (s \cdot m)_{Cu}$.

Ahora bien, tomando valores obtenidos en espectroscopia atòmica (Handbook of Spectroscopy, 1974), de los coeficientes de atenuación màsica en función de la energía de excitación (E_0) , obtenemos la razòn del coeficiente de atenuación màsica del niquel con respecto a la del cobre $(/N_i//C_u)$ en función de la energía de excitación (E_0) :

E _O (Kev)	$(r_{\rm Ni}/r_{\rm Cu})$
9	0.949
10	0.951
12	0.949
15	0.947
17	0.945
20	0.947
25	0.945
30	0.944
35	0.945
40	0.945

en en fan de skriveren en de skriveren en de skriveren en skriveren en skriveren en skriveren en skriveren en s Er en skriveren en sk 66

Entonces, el promedio de (Γ_{Ni}/Γ_{Cu}) estarà dado por:

(FNi/Cu)=0.948

por lo tanto, la densidad superficial del cobre $(S \cdot m)_{Cu}$ es proporcional a la densidad superficial del niquel $(S \cdot m)_{Ni}$ por un factor de 0.948, es decir,

$(S \cdot m)_{Cu} = 0.948(S \cdot m)_{Ni}$

La Figura 1, muestra el coeficiente de absorción màsica del cobre y del niquel en función de la energia de la radiación incidente.

Utilizando el procedimiento anterior, se obtuvo el listado de filtros balanceados para rayos-X de fluorescencia de todos los elementos a partir del nùmero atòmico Z=15 (H.A. Adriano,et. al.,1986) que se muestra en la Tabla A, indicando el càlculo obtenido de las densidades superficiales de los filtros adyacentes, el elemento de interés y las lincas en ventana.


TABLA A

••

FILTROS BALANCEADOS

		Filtro des de	s y bor- absorciòn				Lineas en Ve	Balanceo de los Filtros			
1	Elemento de Interes	F1=Kabs (Kev)	F2=Kabs (Kev)	КЪ2	Kb 1	Kal	Ka2	Lg1	Lb1	Lai	(Sm)=[mg/cm2]
15	۴	Si = 1.838	F = 2.142		P	P	P		Sr-Y-Zr	Y-2r	0.86 Sm(Si) = 5m(P)
16	5	P = 2.142	5 = 2.470		5	S	5	2r	Nb-No	Nb-Ma-Tc	0.82 Sm(P) = Sm(S)
17	C1	5 = 2.470	Cl = 2.819		C1	C1	C1 .	Ho-Tc	Tc-Ru	Ru-Rh	$0.89 \mathrm{Sm}(\mathrm{S}) = \mathrm{Sm}(\mathrm{Cl})$
18	Ar	C1 = 2.819	Ar = 3.203		Ar	Ar	Ar	Ru-Rh	Rh-Pd-Ag	Pd-Ag-Cđ	0.89 Sm(C1) = Sm(Ar)
19	ĸ	Ar = 3.203	K = 3.607		K	K	K	Pd-Ag	Cd-In	In-Sn-Sb	0.82 Sm(Ar) = Sm(K)
20	Ca	K = 3.607	Ca = 4.03B		Ca	Ca	Ca	Cd-In	Sn-Sb-Te	Te-1	$0.85 \mathrm{Sm}(\mathrm{K}) = \mathrm{Sm}(\mathrm{Ca})$
21	Sc	Ca = 4.038	Sc = 4.496		Sc	Sc	Sc	Sn-Sb	1-Xe	Xe-Cs-Ba	$0.94 \operatorname{Sm}(\operatorname{Ca}) = \operatorname{Sm}(\operatorname{Sc})$
22	Ti	Sc = 4.496	Ti = 4.964		π	u	TI-V	Te-1	Cs-Ba	La-Ce	0.91 Sn(Sc) = Sm(Ti)
23	v	Sc = 4,496	Ti = 4.964		Ti	Ti	ti-V	Te-I	Cs-Ba	La-Ce	0.90 Sm(Sc) = Sm(Ti)
24	Cr	Ti = 4.964	V = 5.463		V	Cr	Cr	Xe-Cs	La-Ce	Pr-Nd-Pm	0.91 Sm(Ti) = Sm(V)
25	8n	V = 5.463	Cr = 5.988		Cr	Ma	Ma	Ba-La	Fr-Nd-Pm	Sa-Eu	0.86 Sm(V) = Sm(Cr)
26	Fe	Cr = 5.988	Mn = 6.537		No	Fe	Fe	Ce-Pr	Sm-Eu	Gd-Tb-Dy	0.92 Sm(Cr) = Sm(Mn)
27	Co	Mn = 6.537	Fe = 7.111		Fe	Ca	Co	Nd-Pm	6d-TB	Ho-Er	0.88 S#(Mn) ≈Sm(Fe)
79	Ni	Fe = 7,111	Co = 7.709		Co	N	Ni	Sm-Eu	Dy-Ho	Tm-Yb-Lu	0.90 Sa(Fe) = Sa(Co)
29	Cu	Co = 7,709	Ni = 8.331	Ni	Ni	Cu	Cu	Gd-Tb	Er-Ta	Hf-Ta	0.90 Sm(Co) = Sm(Ni)
30	Zn	Ni = 8.331	Cu = 8.980	Cu	Cu	Zn	Zn	Dy-Ka	Yb-Lu	W-Re-Os	0.95 Sm(Ni) = Sm(Cu)

FILTROS BALANCEADOS

					Balanceo de los Filt						
7	Elemento de Interes	F1=Kabs (Kev)	F2=Kabs (Kev)	КЪ2	Kb 1	Ka1	KaZ	Lg1	Lb1	La1	(Sn)=[øg/cm2]
31	Ga	Cu = 8.980	In = 9.660	Zn	Zn	6a	Ga	Er-Ta		Ir-Pt	0,90 Sa(Cu) = Sa(Zn)
32	Ge	Zn = 9.660	6a = 10.36B	6a	6a	Ge	Ge	Yb-Lu	K-Re-Ds	Au-Hg-Tl	$0.96 \operatorname{Sm}(In) = \operatorname{Sm}(Ga)$
32	As	Ga = 10.369	Ge = 11.103	6e	Ge	As	As	Xf-Ta	Ir-Pt	Pb-Bi	0.95 Sm(6a) = Sm(6e)
34	Se	Ge = 11.103	As = 11.863	As	As	Se	Se	V-Re	- Au-Hg	Fo-At-Rn	0.90 Sa(Ge) = Sa(As)
35	Br	As = 11.863	Se = 12.652	Se	As	Br-Kr	Br	_Os-Ir	TI-Pb	Fr-Ra-Ac	0.94 Sm(As) = Sm(Se)
36	Kr	As = 11.863	Se = 12.652	Se	As	Kr-Br	Kr	Os-Ir	T1-Pb	Fr-Ra-Ac	0.94 Sm(As) = Sm(Se)
37	Rb	Se = 12.652	8r = 13,475	Br	Br	Rb	Rb	Pt-Au	Bi-Fo	Th: Pa	0.92 Sm(Se) = Sm(Br)
38	Sr	Br = 13.475	Kr = 14.323	Kr	Kr	Sr	Sr	Hg-T]	At-Rn	U-Np-pu	0.95 5m(Br) = Sm(Kr)
39 Ě	7 ^Y	Kr = 14.323	Rb = 15.201	Rb	Rb	Ŷ	, γ	Pb	Fr	Aa-Ce	0.93 Sm(Kr) = Sm(Rb)
40 3	2r	Rb = 15.201	Sr = 16.106	Sr	Sr	Zr	۲	Bi-Po	Ra-Ac	Bi -Cf	0.93 Sm(Rb) = Sm(Sr)
41 7	F. Nb	Sr = 16.106	Y = 17.037	Ŷ	Ŷ	Nb	Nb	At-Rn	Th-Pa		(1.92 Sp(Sr) = Sm(Y)
42 5 3	Mo	Y = 17.037	Zr = 17.998	Zr	۲r	Ko	Ko	Fr-Ra	U-Np		0.95 Sa(Y) = Sa(Zr)
43 8	Ξ, Tc	Zr = 17.998	Nb = 18.987	Nb	Nb	Τc	٦٢	Ac-Th	Fu-An		0.93 Sm(Zr) = Sm(Nb)
44	Ru	Nb = 18.987	No = 20.092	Ho	Ho	Ru	Ru	Pa	Ca-Bk		0.94 S#(Nb) = S#(Ma)
45 \$	Rh	Ho = 20.002	Tc = 21.054	Tc	٦c	Rh-Pd	Rh	U-Np	Cf		0.94 Sm(Mo) = Sm(Tc)
45	Fd	Tc = 21.054	Ru = 22.118	Ru	Ru	Fd	Ag	Pu-As	in a start		0.94 Sa(Tc) = Sa(Ru) (

							Balanceo de los Filtros				
Z	Elemento de Interes	F1=Kabs (Kev)	F2=Kabs (Kev)	Kb2	Kb1	Kal	Ka2	Lg1	LB1	Lai	(Sm)=[mg/cm2]
47	Ag	Ru = 22.118	Rh = 23.224	Rh	Rh	Ag-Cd	Cd	Cn			$0.95 \operatorname{Sm}(\operatorname{Ru}) = \operatorname{Sm}(\operatorname{Rh})$
48	Cď	Ru = 22.11B	Rh = 23.224	Rh	Rh	Cd-Ag	Cd	Cn			$0.95 \operatorname{Sm}(\operatorname{Ru}) = \operatorname{Sm}(\operatorname{Rh})$
49	In	Rh = 23.224	Pd = 24.347	Rh	Pd	In	In	Bk-Cf	leni - Mala		$0.96 \operatorname{Sm}(\operatorname{Rh}) = \operatorname{Sm}(\operatorname{Pd})$
50	Sn	Pd = 24.347	Ag = 25.517	Ag	Ag	Sn	Sn				0.94 Sm(Pd) = Sm(Ag)
51	Sb	Ag = 25.517	Cd = 26.712	Cd	Cd	Sb	Sb				0.96 Sm(Ag) = Sm(Cd)
52	Te	Cd = 26.712	In = 27.928	In	In	Te	Te				0.92 Sa(Ag) = Sa(In)
53	1	In = 27.928	Sn = 29.190	Sn	Sn	I	1				0.99 Sm((n) = Sm((Sn))
54	Ĭe	Sn = 29.190	Sb = 30.486	Sb	Sb	Ĭe	Xe		an an an Arran an Arran an An Arran an Arran an Arran an Arran an Arran an		0.73 Sa(Sn) = Sa(Sb)
55	Cs	Sb = 30.486	Te = 31.809	Te	Te	Cs	Cs				0.97 Sm(Sb) = Sm(Te)
56	Ba	Te = 31.809	1 = 33.164	I	1	Ba	Ba-La				0.94 Sm(Te) = Sm(1)
57	La	1 = 33.164	Xe = 34.579	Xe	Xe	La	Ce			- i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	0.78 Sm(1) = Sm(Xe)
58	Ce	Xe = 34.579	Cs = 35.959	Cs	Cs	Ce	Fr				0.93 Sm(Xe) = Sm(Cs)
59	Pr	Cs = 35.959	Ba = 37.410	Ba	Ba	Pr-Nd	Nd				0,97 Sm(Cs) = Sm(Ba)
60	Nd .	Cs = 35.959	Ba = 37.410	Ba	Ba	Nd-Fr	Nd				0.97 Sm(Cs) = Sm(Ba)
61	Рл	Ba = 37.410	La = 38.931	La	La	Pm	Pa				0,95 Sm(Ba) = Sm(La)
62	Sa	La = 38.931	Ce = 40.449	Ce	Ce	Sn	Sa				0.94 Sm(La) = Sm(Ce)

FILTROS BALANCEADOS

			에게 가격하는 것 같은 가 관람				Balanceo de los Filtros				
2	Elemento de Interes	F1=Kabs (Kev)	F2=Kabs (Kev)	Kb2	K6 1	Kal	Ka2	Lg1	Lb1	Lai	(Sm)=[mg/cm2]
63	Eu	Ce = 40.449	Pr = 41.998	Pr	Pr	Eu	Eu				0.74 Sm(Ce) = Sm(Pr)
64	Gd	Pr = 41.998	Nd = 43.571	- Nd	Nd		Gd				$0.97 \operatorname{Sn}(\operatorname{Pr}) = \operatorname{Sn}(\operatorname{Nd})$
65	ĩb	Nd = 43.571	Pm = 45.207	Pø	Pø	Tb	Tb-Dy			laria Second	0.95 Sm(Nd) = Sm(Pm)
66	Dy	Pa = 45.207	5m = 46.846	Sa	Se	Dy	Ho				0.96 Sn(Fm) = Sn(Sm)
67	Ho	Sa = 46.846	Eu = 48.515	Eu	Eu	Ho	Er				0.95 Sm(Sm) = Sm(Eu)
68	Er	Eu = 48.515	Gd = 50.229	Gd	Gd	Ĺr ,	In				0.98 Sm(Eu) = Sm(Gd)
69	Ta	Gd = 50.229	Tb = 51.998	Tb	Tb	Ta	Yb				0.95 Sæ(Gd) = Sa(Tb)
70	Yb	Tb = 51.998	Dy = 53.789	Dy	Dy	ҮЪ	Lu				0.97 Sm(Tb) = Sm(Dy)
71	Lu	Dy = 53.789	Ho = 55.615	Ha	Ho	Lu	H				0.96 Sm(Dy) = Sm(Ha)
72	HI	Ha = 55.615	Er = 57.483	Er	Er	Hf	Ta				0.96 Sm(Ho) = Sm(Er)
73	Ta	Er = 57.4B3	Tm = 59.335	Ta	Ta	Ta	N				0.96 Sm(Er) = Sm(Tm)
74	N	Er = 57,483	Tm = 59.335	โล	Ta	Ta					0.96 Sm(Er) = Sm(Tm)
75	Re	Tm = 59,335	Yb = 61.303	Yb	Lu	Re	Re				0.97 Sm(Tm) = Sm(Yb)
76	Os	Yb = 61.303	Lu = 63.304	La	Hf	Os	Ds-Ir				0.96 Sm(Yb) = Sm(Lu)
77	Ir	Lu = 63.304	Hf = 65.313	HI	Ţa	lr	Pt				0.98 Sm(Lu) = 5m(Hf)
78	Ft	HF = 65,313	Ta = 67.400	Ta	N	Pt	Au		a atry i eg Gr		0.98 Sm(Hf) = Sm(Ta)

										•
						Lineas en Ven	itana			Balanceo de los Filtro
Elemento de Interes	F1=Kabs (Kev)	F2=Kabs (Kev)	K62	11	Kal	Ka2	Lg1	Lb1	La1	(Sn)=[mg/cm2]
Au	Ta = 67.400	W = 69.508	W	Re	Au	Hg		n an an an An Saistean Anna Aistean An Anna Anna	n na ser Al ser a se Al ser a	0.96 Sm(Ta) = Sm(W)
Kg	N = 67.508	Re = 7.662	Re	Os	. Hg	n		-		0.95 Sn(W) = Sm(Re)
11	Re = 7.662	05 = 73.860	Ds	łr	11	Pb		a lan aglalana San ang san ag		0.97 Sn(Re) = Sm(Ds)
Fb	0s = 73.860	Ir = 76.097	lr -	Pt	. Pb —	Bi				0.96 Sm(Os) = Sm(Ir)
Bi	Ir = 76.097	Pt = 78.379	Pt	ku	Bi	Po		andronen Sig		0.99 Sm(Ir) = Sm(Pt)
Po	Pt = 78.379	Au = 80.713	Au	Kg	Po	At				0.96 Sm(Pt) = Sm(Au)
At	Au = 80.713	Hg = 83.106	Hg	ħ	At	Rn	n la factoria de la com Transferia de la composición En la composición de			0.97 Sm(Au) = Sm(Hg)
Rn	Hg = 83.106	TL = 65.517	TI -	R)	Rn	Fr-Ra				0.97 Sm(Hg) = Sm(T1)
Fr	T1 = 85.517	Pb = 88.001	Pb	DI	Fr	Ac				0.99 Sm(T1) = Sm(Pb)
Pa	Pb = 88.001	Bi = 90.520	Bi	Po	Ra	Th		in the second		0.94 Sm(Pb) = Sm(Bi)
Ac	Bi = 90.520	Po = 93.112	Fo	At	Ac	Pa				0.96 Sm(Bi) = Sm(Po)
Th	Po = 93.112	At = 95.740	At	Ra	Th	U				0.96 Em(Po) = Sm(At)
Fa	At = 95.740	Rn = 98.418	Rn	fr	Pa	Np				1.01 Sn(At) = Sm(Rn)
U	Rn = 98.418	Fr = 101.147	Fr	Ra	U-Np	Pu				0,97 Sm(Rn) = Sm(Fr)
Np	Rn = 98.418	Fr = 101,147	Fr	Fa	Np-V	fu				0.97 Sm(Rn) = Sm(Fr)
Pu	Fr = 101.147	Ra = 103.927	Ra	Ác.	₽u	Ar				$0.97 \mathrm{Sm}(\mathrm{Fr}) = \mathrm{Sm}(\mathrm{Ra})$

a serie a seri A serie Manual a serie s

N

FILTROS BALANCEADOS

		Lineas en Ventana	Balanceo de los Filtros
Elemento de Interes	F1=Kabs (Kev)	F2=Kabs Kb2 Kb1 Ka1 Ka2 Lg1 Lb1 La1 (Kev)	(Sm)=[mg/cm2]
An	Ra = 103.927	Ac = 106.759 AC This An Ca	$0.96 \operatorname{Sm}(\operatorname{Ra}) = \operatorname{Sm}(\operatorname{Ac})$
Ce	Ac = 106.759	Th = 109.630 Th Pa Ca Rk-Cf	1.01 Sm(Ac) = Sm(Th)
Bk	Th = 107.630	Pa = 112.581 Pa U Bk Cf	0.92 Sm(Th) = Sm(Pa)
Cf	Pa = 112.581	U = 115.591 U Np Cf Fa	$1.03 \operatorname{Sn}(\operatorname{Pa}) = \operatorname{Sn}(U)$

Ζ

BIBLIOGRAFIA

74

H. Arriola S. , J.M. Bravo. "Curso de Instrumentación Nuclear". UNAM , Facultad de Ouimica . División de Estudios de Posgrado . Departamento de Ciencias Nucleares, México, D.F., 1983.

H. Arriola S. , H.A. Adriano C. , F. Ramirez. "Filtros Balanceados para Rayos-X" XXI Congreso Mexicano de Ouimica Pura y Aplicada. Oaxaca, Oax. 1986.

Arthur Beiser. "Conceptos de Fisica Moderna" Mc. Graw-Hill, México, 1977.

Enrico Fermi. "Nuclear Physics" The university of CHicago Press, 1967. The define the state of the sta

Handbook of Spectroscopy Volumen I, J.W. Robinson, CRC Press, Inc., 1974.

Jenkins Ron. "Quantitative X-Ray Spectrometry" Marcel Dekker, Inc., 1981.

Glenn F. Knoll. "Radiation Detection and Measurement" John Willey and Sons, 1979.

Manual Ortec, 1985. "Detector Ortec de "Ge-Hiperpuro" GLP. 16195/10 .

Willian J. Price. "Nuclear Radiation Detection" Mc. Graw-Hill Book Company, 1964.

Eisberg R., Resnick R. "Fìsica Cuàntica" Ed. Limusa, Mèxico,1979.

V. Valkovic. "Trace Element Analysis" Halsted Press, Division John Wiley and Sons Inc., New York, 1975.

Vlado Valkovic. Detection of Characteristic X-Ray: Methods and Applications". Adivisory Group on Applied Nuclear Physics. San Jose, Costa Rica,1977.

Wehr M.R. and Richards J.A. "Physics of the Atom" Addison Wesley, 1977

Woldseth Roff. "All you ever wanted to know about X-Ray Energy Spectrometry" Kevex Corporation. Burlingame, California,1973.